

シリアル EEPROM シリーズ 汎用 EEPROM

Plug & Play 用 EEPROM

BR34E02-3

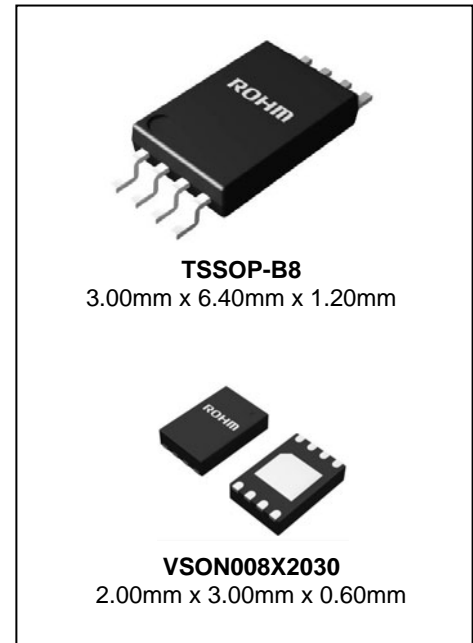
●概要

BR34E02-3 は 256 ワード×8 ビット構成のシリアルプレゼンスディテクト (SPD) 対応シリアル EEPROM です。

●特長

- 256 ワード×8 ビット構成の 2K ビットシリアル EEPROM
- 電源電圧動作範囲が広い(1.7V~5.5V)
- 2 線式シリアルインタフェース
- データ書き換え時の自動消去、自動終了機能
- ページライトモード機能(16byte)
- ライトプロテクト機能
 - 設定/解除可能なライトプロテクト機能 : 00h-7Fh
 - ワンタイムロムによるライトプロテクト機能 : 00h-7Fh
 - WP 端子によるハードライトプロテクト機能 : 00h-FFh
- 低消費電流
 - ライト動作時 (1.7V 時) : 0.4mA(Typ.)
 - リード動作時 (1.7V 時) : 0.1mA(Typ.)
 - 待機時 (1.7V 時) : 0.1μA(Typ.)
- 誤書き込み防止機能
 - WP(ライトプロテクト)機能
 - 低電源電圧時の書き込み禁止
- 高信頼性微細 CMOS プロセス
- 1,000,000 回データ書き換えが可能
- 40 年間データ保持可能
- SCL・SDA 端子にノイズフィルタ内蔵
- 出荷時データ全アドレス FFh

●パッケージ W(Typ.) x D(Typ.) x H(Max.)



●BR34E02-3

容量	ビット形式	形名	電源電圧	パッケージ
2Kbit	256x8	BR34E02FVT-3	1.7V~5.5V	TSSOP-B8
		BR34E02NUX-3		VSON008X2030

●絶対最大定格(Ta=25°C)

項 目	記 号	定 格	単 位	備 考
印加電圧	V _{CC}	-0.3~+6.5	V	
許容損失	P _d	330 (TSSOP-B8)	mW	Ta=25°C以上で使用する場合は、1°Cにつき 3.3mW を減じる。
		300 (VSON008X2030)		Ta=25°C以上で使用する場合は、1°Cにつき 3.0mW を減じる。
保存温度範囲	T _{stg}	-65~+125	°C	
動作温度範囲	T _{opr}	-40~+85	°C	
各端子電圧(A0)	-	-0.3~10.0	V	
各端子電圧(その他)	-	-0.3~V _{CC} +1.0	V	
静電破壊耐圧 (人体モデル)	V _{ESD}	-4000~+4000	V	

●メモリエル特性(Ta=25°C、V_{CC}=1.7~5.5V)

項 目	規 格 値			単 位
	最小	標準	最大	
データ書き換え回数 *1	1,000,000	—	—	回
データ保持年数 *1	40	—	—	年

*1:Not 100% TESTED

○製品構造：シリコンモノリシック集積回路 ○耐放射線設計はしていません

●推奨動作範囲

項 目	記 号	定 格	単 位
電源電圧	Vcc	1.7~5.5	V
入力電圧	VIN	0~Vcc	V

●電気的特性 (特に指定のない限り、Ta=-40~85℃、Vcc=1.7~5.5V)

項 目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
"H"入力電圧	VIH	0.7 Vcc	-	Vcc+1.0	V	
"L"入力電圧	VIL	-0.3	-	0.3 Vcc	V	
"L"出力電圧 1	VOL1	-	-	0.4	V	IOL=2.1mA、2.5V≤Vcc≤5.5V(SDA)
"L"出力電圧 2	VOL2	-	-	0.2	V	IOL=0.7mA、1.7V≤Vcc<2.5V(SDA)
入力リーク電流 1	ILI1	-1	-	1	μA	VIN=0V~Vcc(A0、A1、A2、SCL)
入力リーク電流 2	ILI2	-1	-	15	μA	VIN=0V~Vcc(WP)
入力リーク電流 3	ILI3	-1	-	20	μA	VIN=VHV(A0)
出力リーク電流	ILO	-1	-	1	μA	VOUT=0V~Vcc
動作時消費電流	ICC1	-	-	2.0	mA	Vcc=5.5V、fSCL=400kHz、tWR=5ms バイトライト、ページライト、 ライトプロテクト
	ICC2	-	-	0.5	mA	Vcc=5.5V、fSCL=400kHz ランダムリード、カレントリード、 シーケンシャルリード
スタンバイ電流	ISB	-	-	2.0	μA	Vcc=5.5V、SDA、SCL=Vcc A0、A1、A2=GND、WP=GND
A0 高電圧	VHV	7	-	10	V	VHV-Vcc≥4.8V

●動作タイミング特性 (特に指定のない限り、Ta=-40~85℃、Vcc=1.7~5.5V)

項 目	記号	規格値			単位
		最小	標準	最大	
SCL 周波数	fSCL	—	—	400	kHz
データクロック"H"時間	tHIGH	0.6	—	—	μs
データクロック"L"時間	tLOW	1.2	—	—	μs
SDA・SCLの立ち上がり時間 *1	tR	—	—	0.3	μs
SDA・SCLの立ち下がり時間 *1	tF	—	—	0.3	μs
スタートコンディションホールド時間	tHD:STA	0.6	—	—	μs
スタートコンディションセットアップ時間	tSU:STA	0.6	—	—	μs
入力データホールド時間	tHD:DAT	0	—	—	ns
入力データセットアップ時間	tSU:DAT	100	—	—	ns
出力データ遅延時間	tPD	0.1	—	0.9	μs
出力データホールド時間	tDH	0.1	—	—	μs
ストップコンディションセットアップ時間	tSU:STO	0.6	—	—	μs
転送開始前バス開放時間	tBUF	1.2	—	—	μs
内部書き込みサイクル時間	tWR	—	—	5	ms
ノイズ除去有効期間(SCL・SDA 端子)	tl	—	—	0.1	μs
WP ホールド時間	tHD:WP	0	—	—	μs
WP セットアップ時間	tSU:WP	0.1	—	—	μs
WP 有効時間	tHIGH:WP	1.0	—	—	μs

*1:Not 100% TESTED

●同期データ入出力タイミング

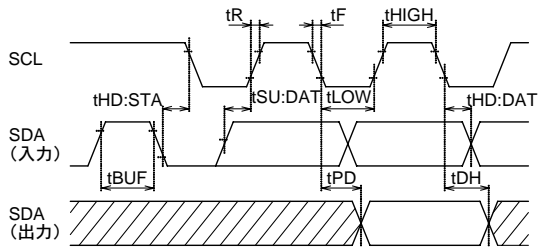


Figure 1-(a). 同期データ入出力タイミング

- SCL の立ち上がりエッジで入力を読み込みを行う。
- SCL の立ち下がりエッジに同期してデータ出力を行う。

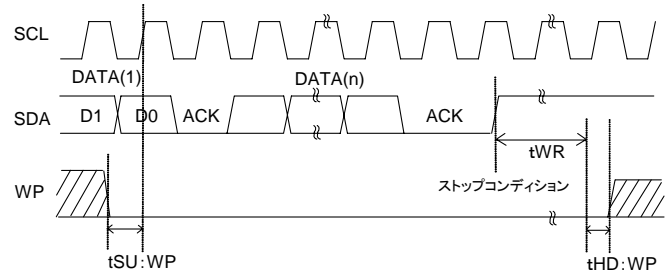


Figure 1-(d). ライト実行時 WP タイミング

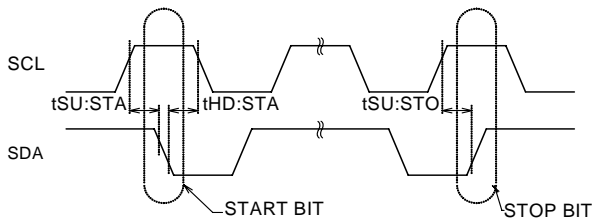


Figure 1-(b). スタート・ストップビットタイミング

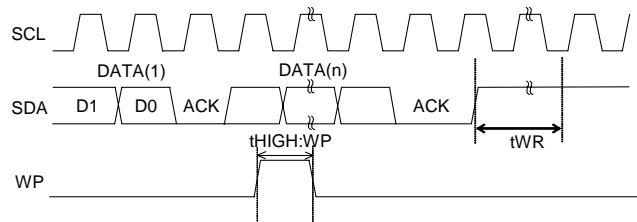


Figure 1-(e). ライトキャンセル時 WP タイミング

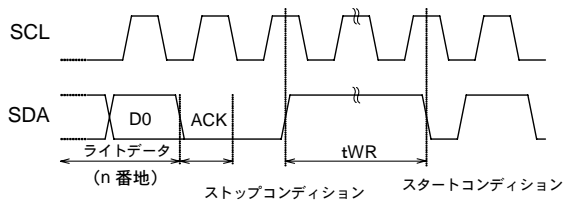
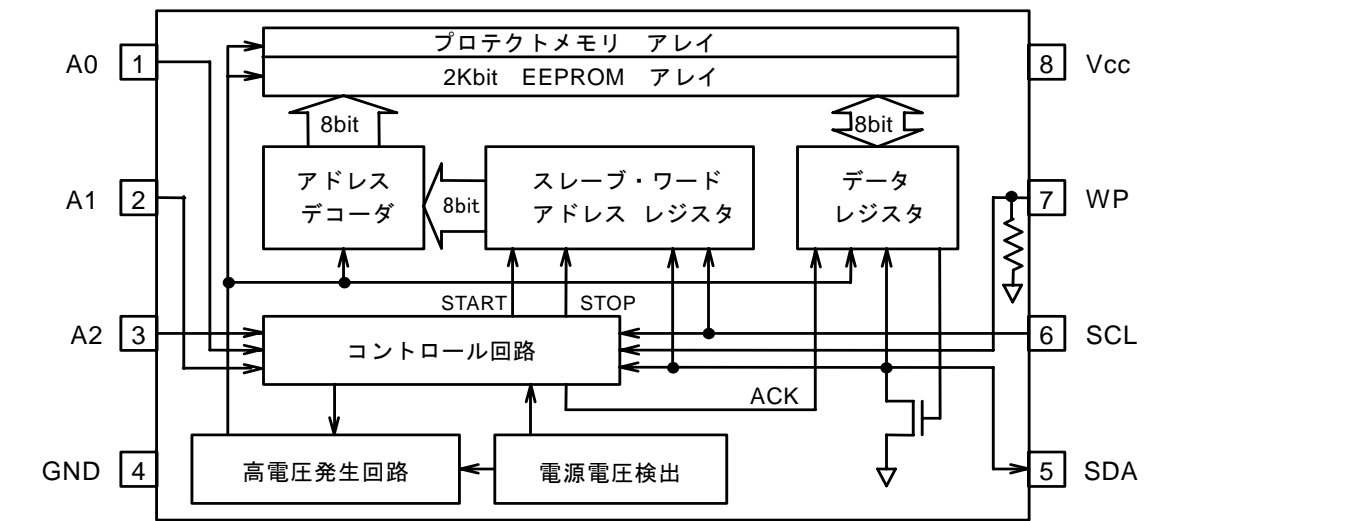


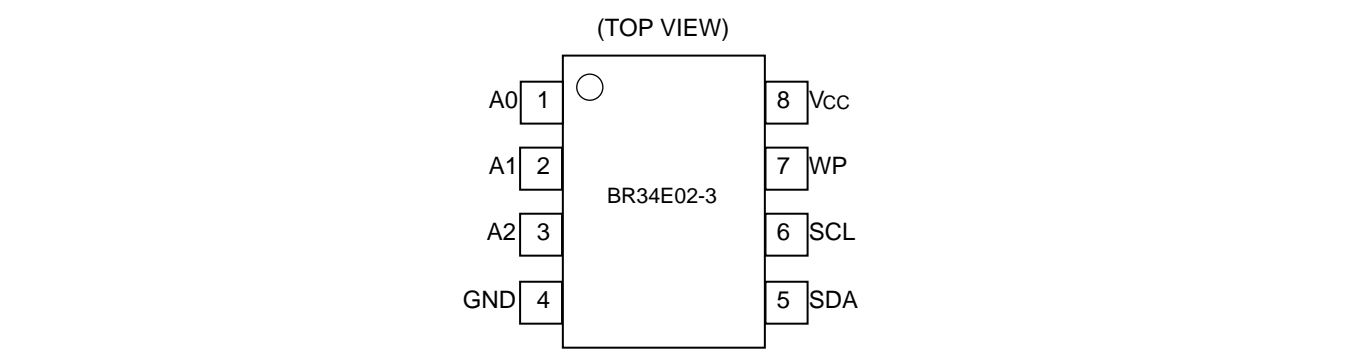
Figure 1-(c). 書き込みサイクルタイミング

- ライト実行時には最初の DATA(1)の D0 取り込みクロック立ち上がりから、tWR までの区間で WP="LOW"としてください。
- その区間で WP="HIGH"とすることで、ライトをキャンセルできます。
- tWR の間に WP を "HIGH"とした場合、書き込みを強制的に終了させるため、アクセス中のアドレスデータは保証されませんので再度書き込みをしてください。

●ブロック図



●端子配置図



●端子説明

端子名	入出力	機能
Vcc	-	電源を接続してください。
GND	-	全入出力の基準電圧、0V。
A0、A1、A2	入力	スレーブアドレス設定端子。 *1
SCL	入力	シリアルクロック入力。
SDA	入力/出力	スレーブ及びワードアドレス *2 シリアルデータ入力・シリアルデータ出力。
WP	入力	ライトプロテクト端子。 *3

*1 A0, A1, A2 ピンはオープンで使用しないで下さい
*2 SDA 端子は、Nch オープンドレインの出力ですので外部にプルアップ抵抗を付加して使用してください。
*3 WP 端子には内部に、プルダウン抵抗がついておりますので、プロテクト機能をご使用されない場合は、オープンまたは GND にしてください。

●特性データ(参考データ)

以下の特性データは Typ.値です。

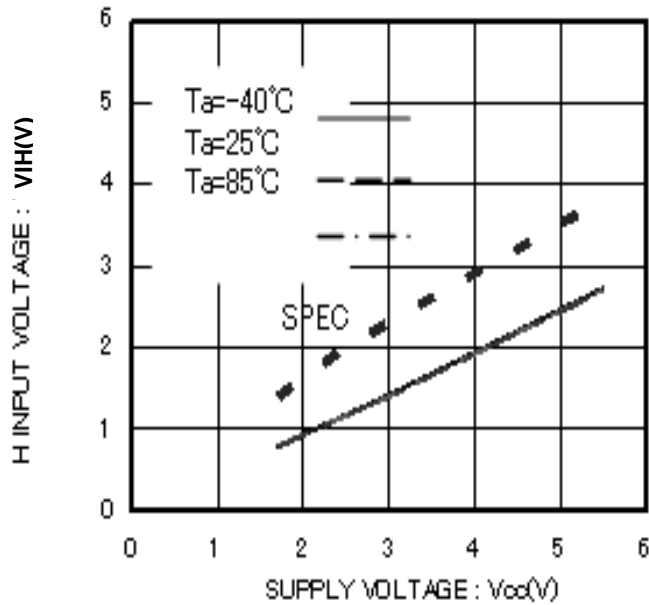


Figure 2. "H" Input Voltage V_{IH}
(A0, A1, A2, SCL, SDA, WP)

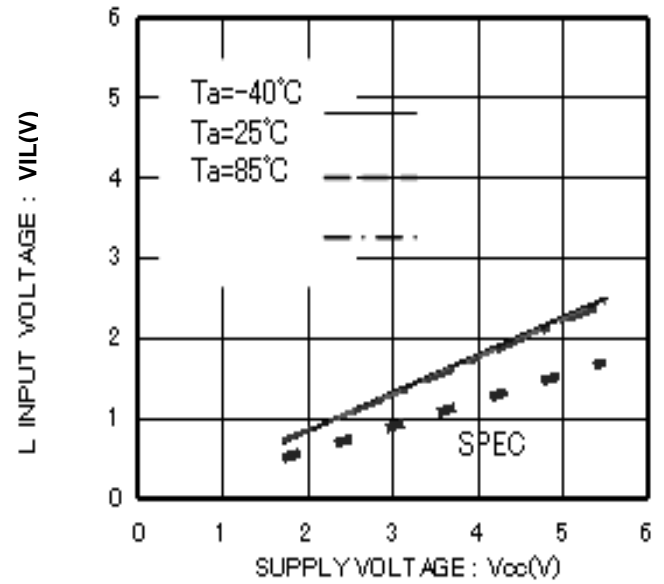


Figure 3. "L" Input Voltage V_{IL} ,
(A0, A1, A2, SCL, SDA, WP)

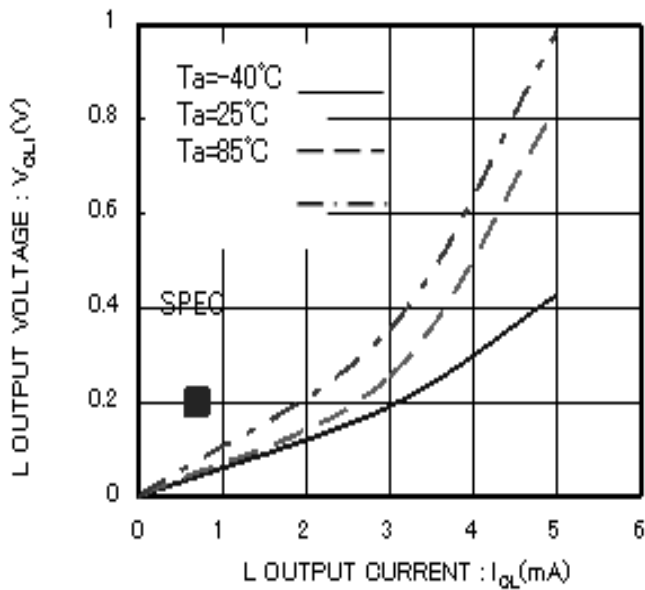


Figure 4. "L" Output Voltage1 $VOL1$
($V_{CC}=2.5V$)

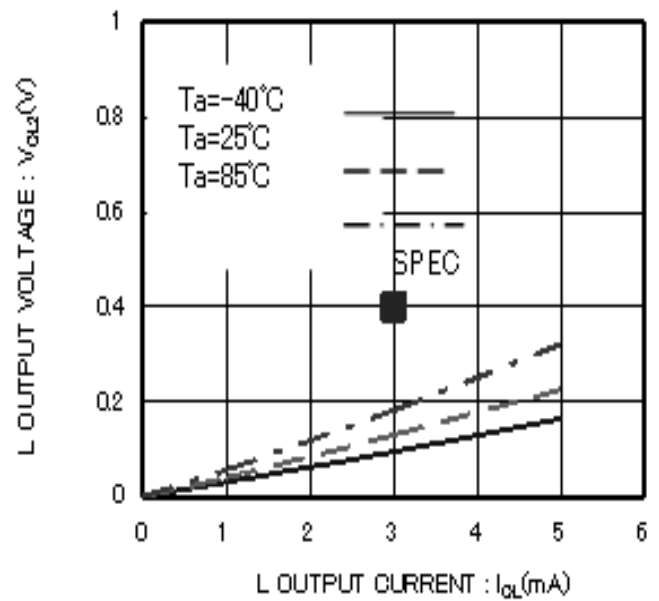
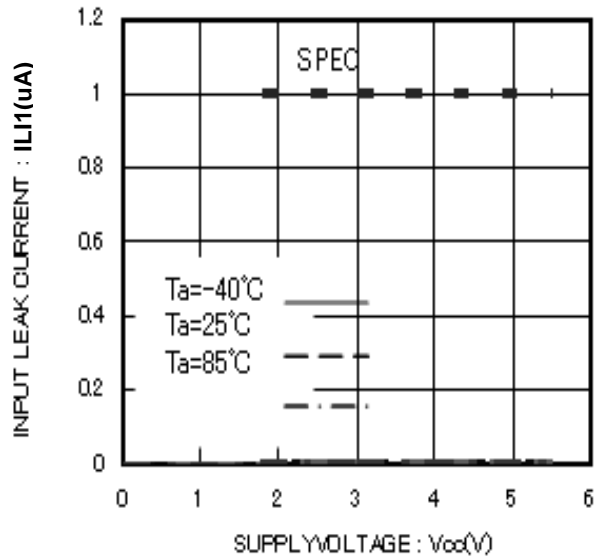
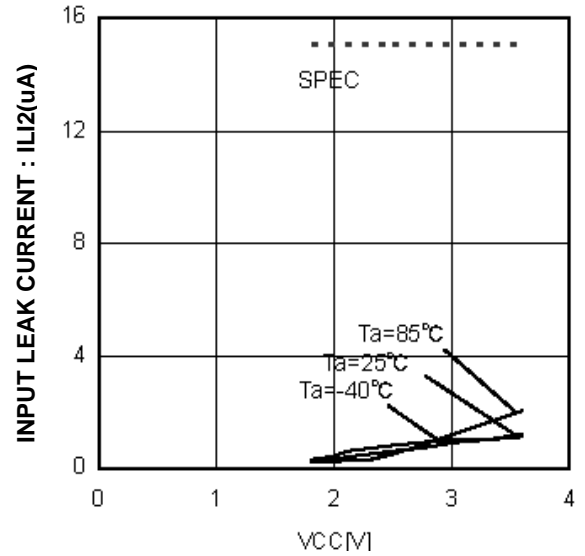
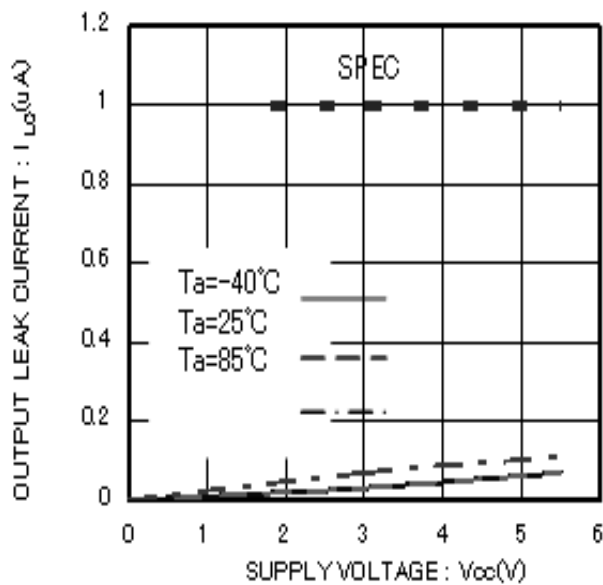
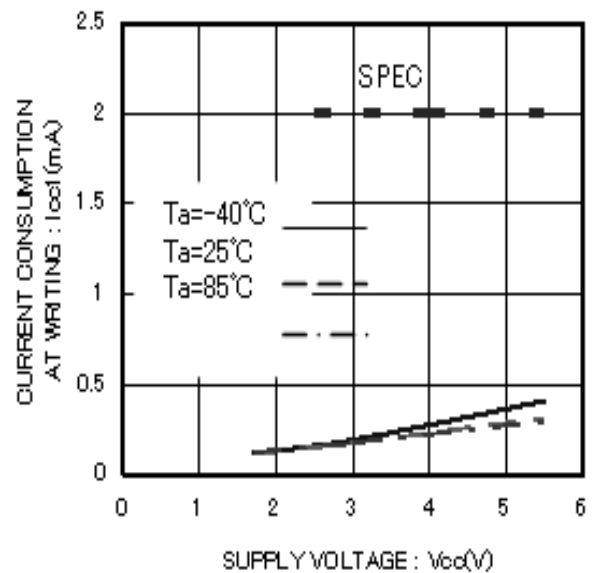


Figure 5. "L" Output Voltage2 $VOL2$
($V_{CC}=1.7V$)

●特性データ(参考データ) - 続き

Figure 6. Input Leakage Current ILI1
(A0, A1, A2, SCL)Figure 7. Input Leakage Current ILI2
(WP)Figure 8. Output Leakage Current ILO
(SDA)Figure 9. Operating Current at WRITE operation ICC1
(fSCL=400kHz)

●特性データ(参考データ) - 続き

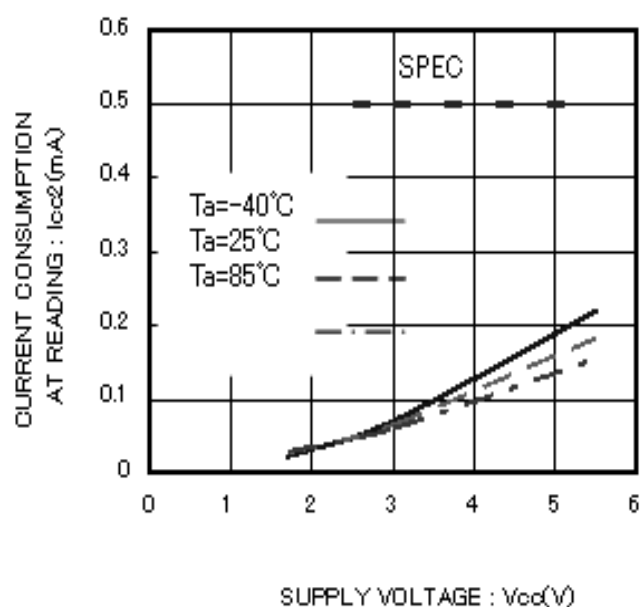


Figure 10. Operating Current at READ operation ICC2 (fSCL=400kHz)

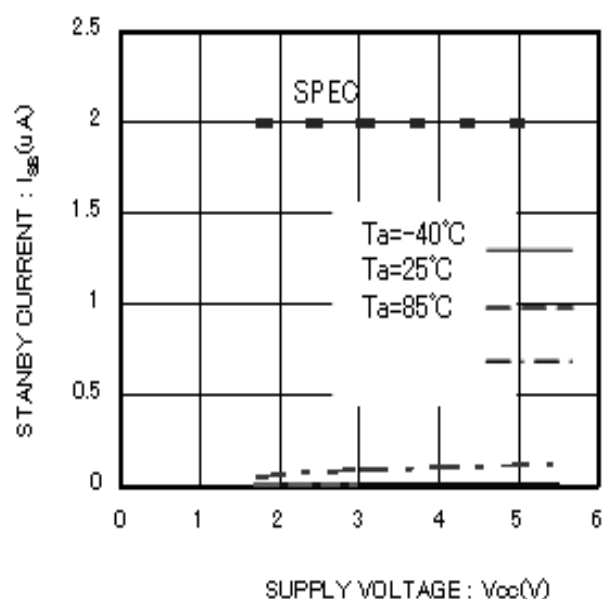


Figure 11. Standby Current ISB

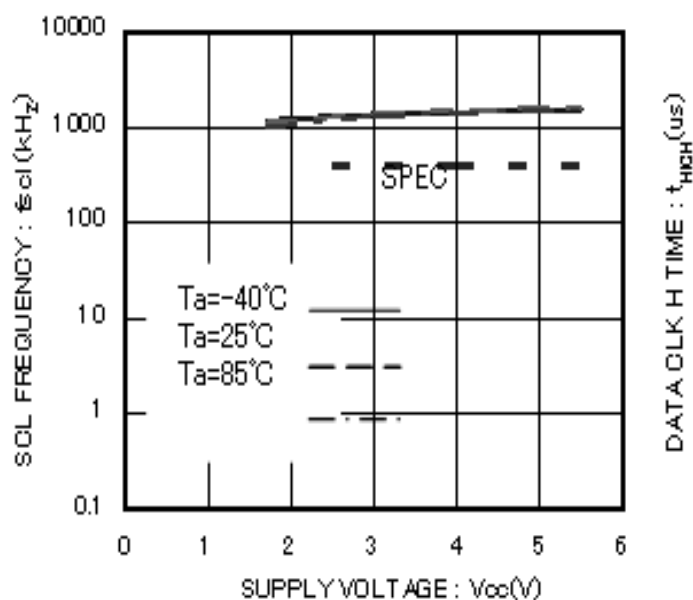


Figure 12. Clock Frequency fSCL

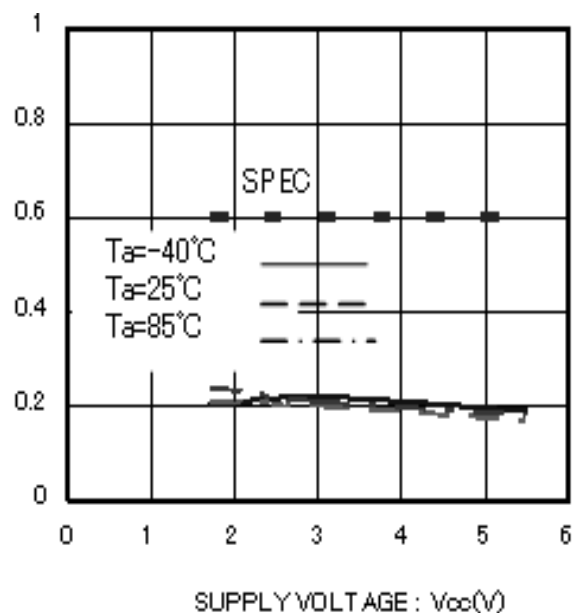
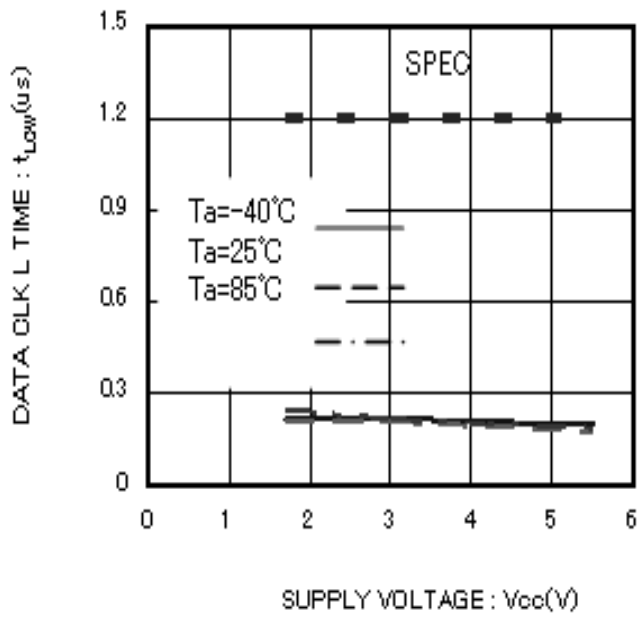
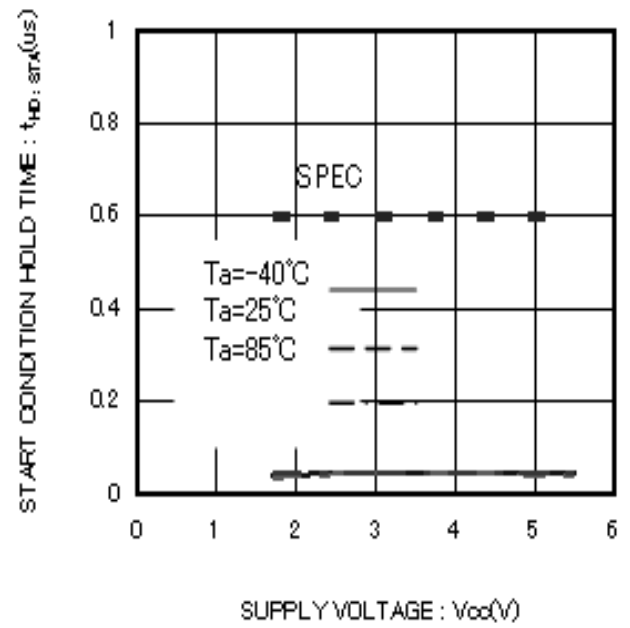
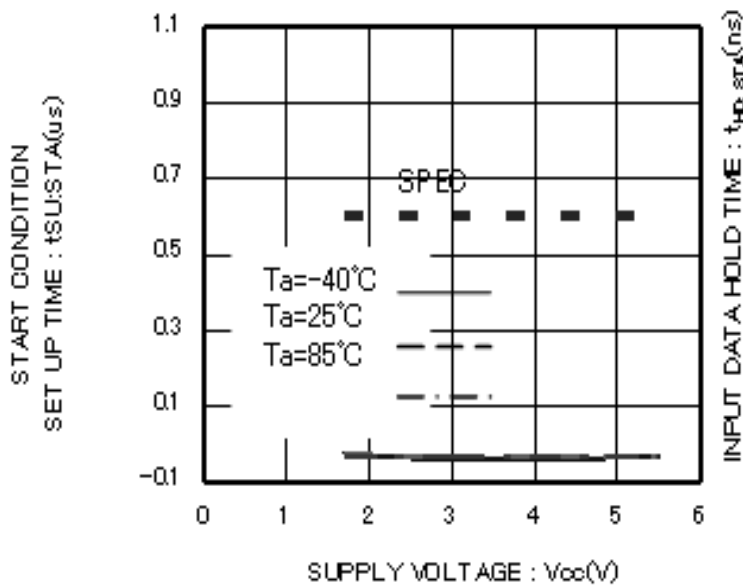
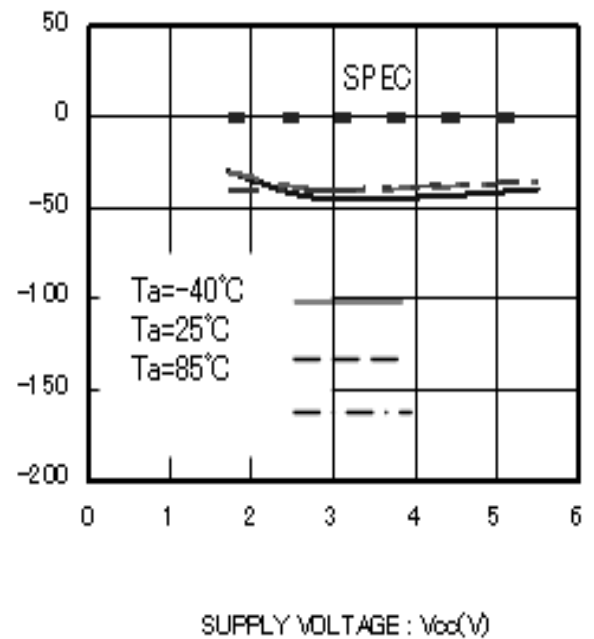
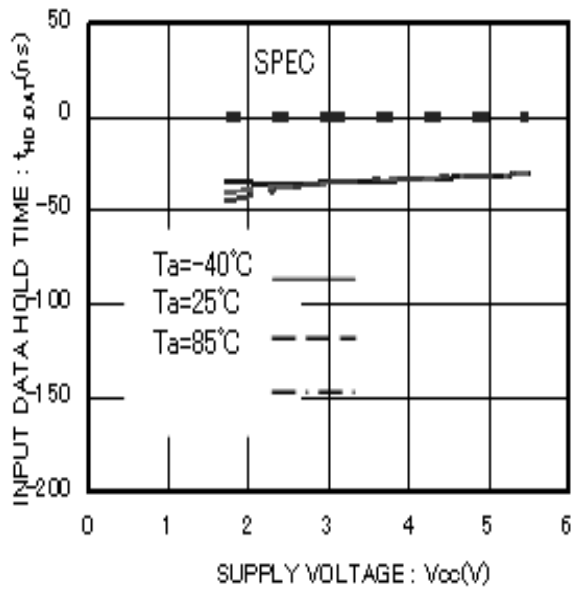
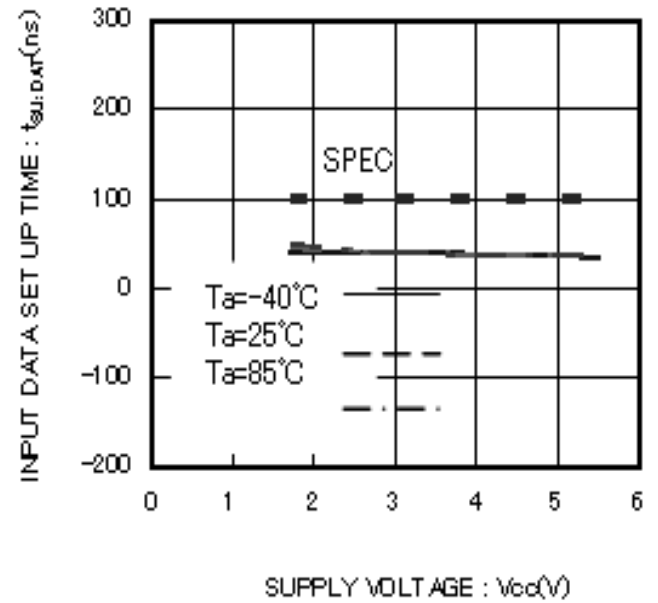
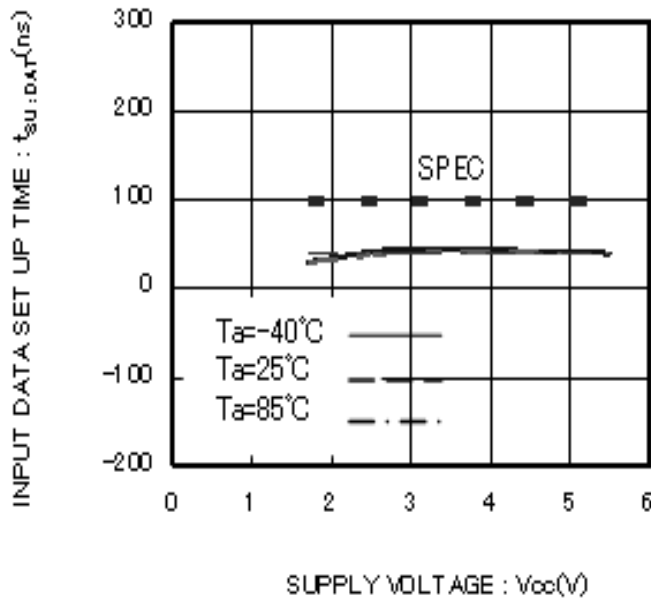
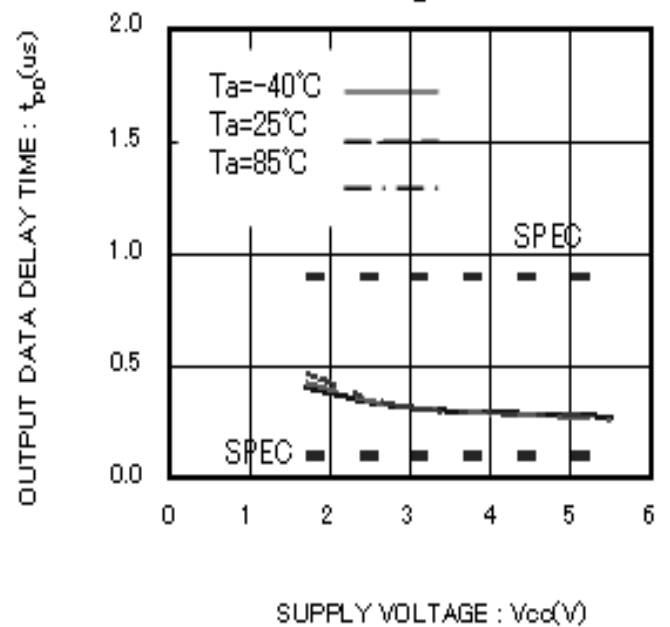


Figure 13. Data Clock High Period tHIGH

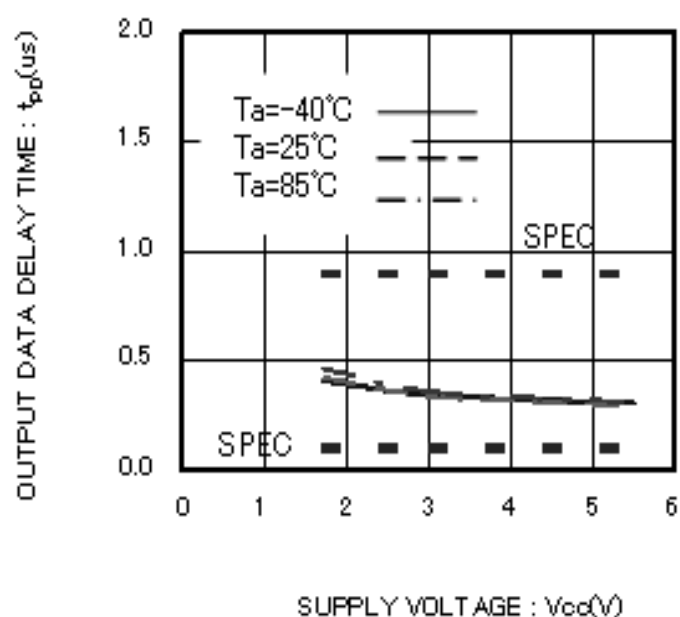
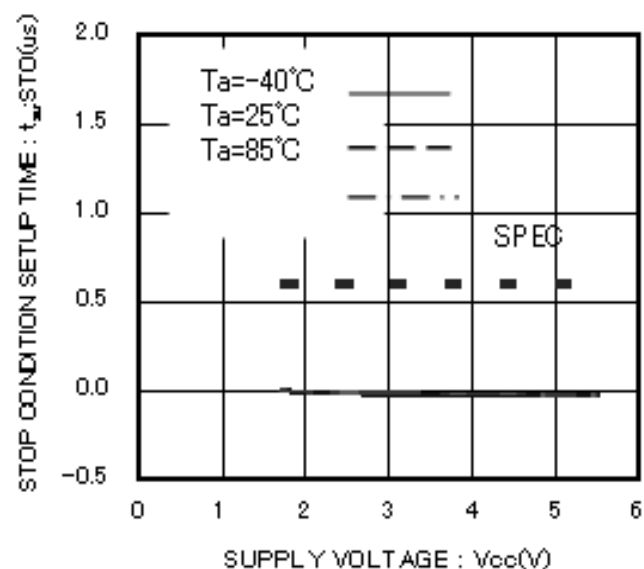
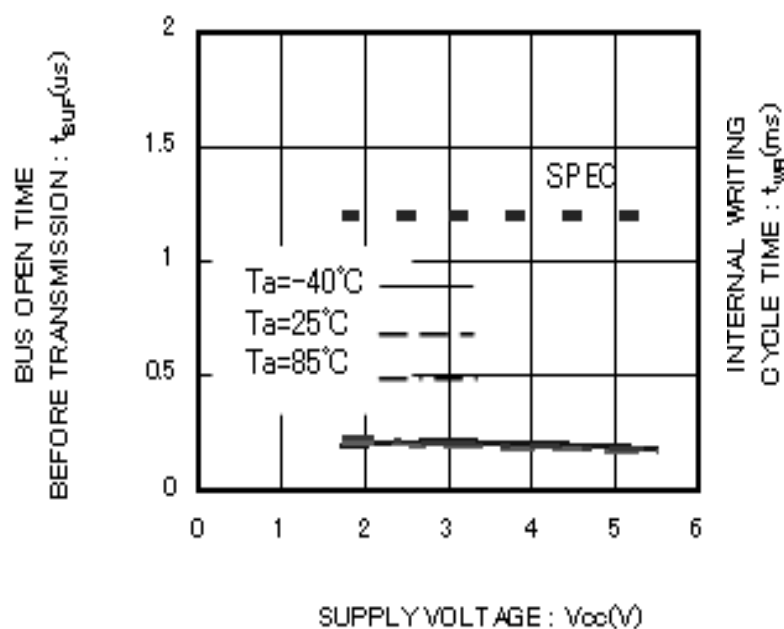
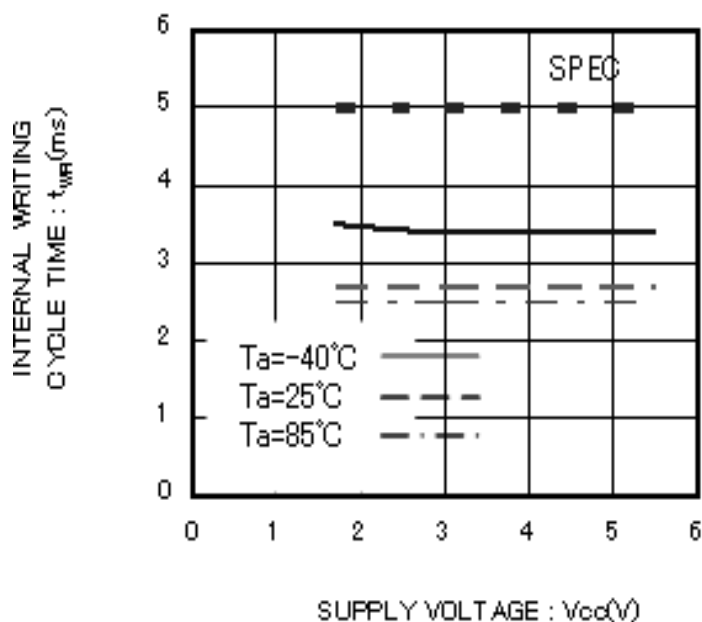
●特性データ(参考データ) - 続き

Figure 14. Data Clock Low Period t_{LOW} Figure 15. Start Condition Hold Time $t_{HD:STA}$ Figure 16. Start Condition Setup Time $t_{SU:STA}$ Figure 17. Input Data Hold Time $t_{HD:DAT(HIGH)}$

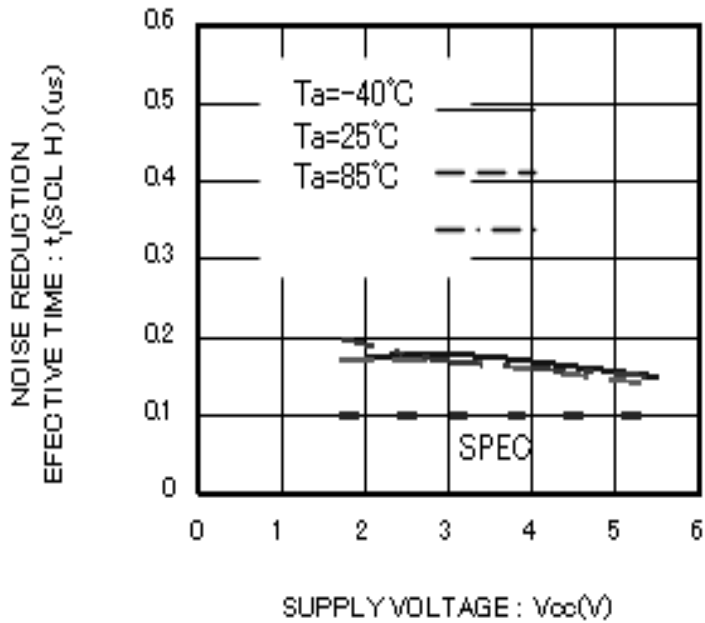
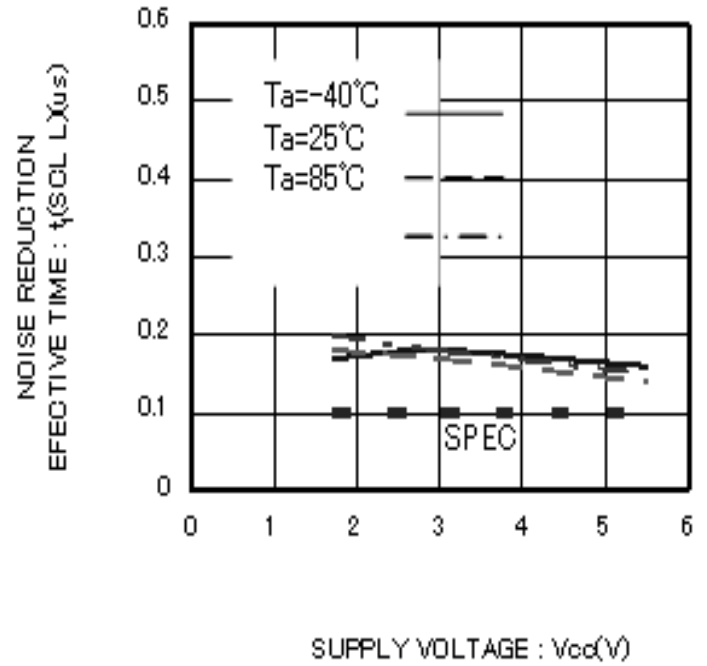
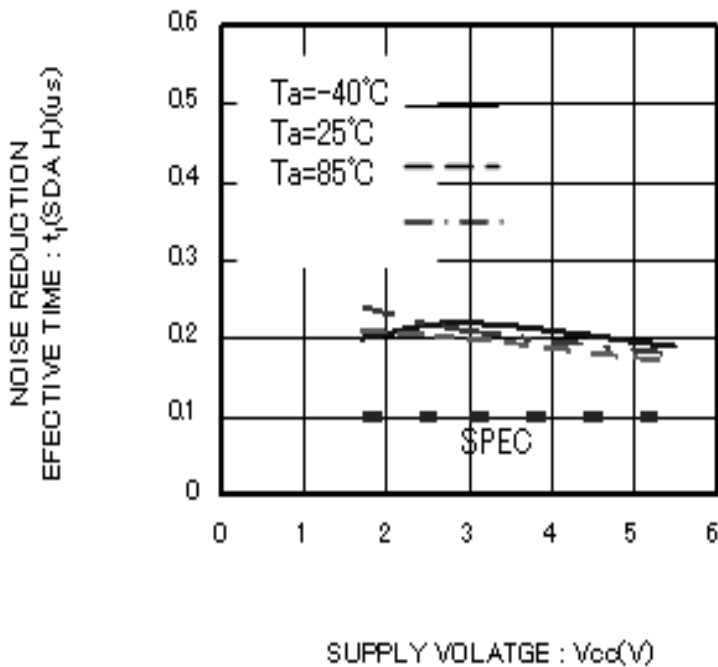
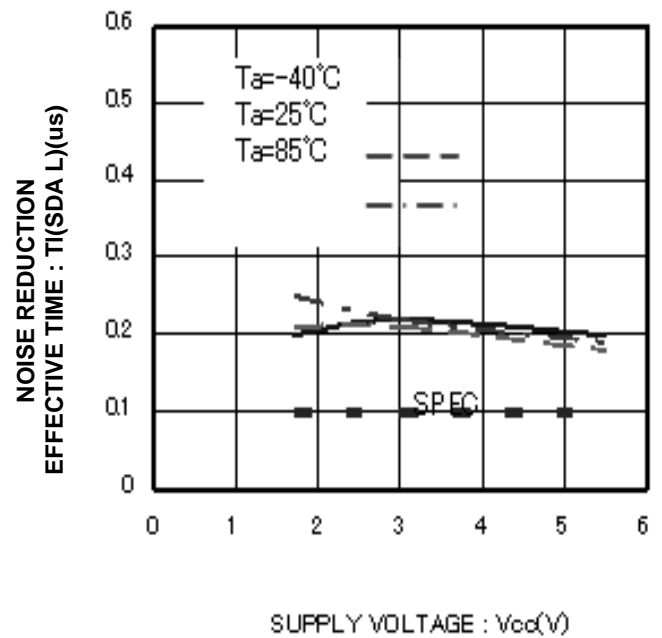
●特性データ(参考データ) - 続き

Figure 18. Input Data Hold Time $t_{HD:DAT}$ (LOW)Figure 19. Input Data Setup Time $t_{SU:DAT}$ (HIGH)Figure 20. Input Data Setup Time $t_{SU:DAT}$ (LOW)Figure 21. 'L' Output Data Delay Time t_{PD0}

●特性データ(参考データ) - 続き

Figure 22. 'H' Output Data Delay Time t_{PD1} Figure 23. Stop Condition Setup Time $t_{SU: STO}$ Figure 24. Bus Free Time t_{BUF} Figure 25. Write Cycle Time t_{WR}

●特性データ(参考データ) - 続き

Figure 26. Noise Spike Width t_I (SCL H)Figure 27. Noise Spike Width t_I (SCL L)Figure 28. Noise Spike Width t_I (SDA H)Figure 29. Noise Spike Width t_I (SDA L)

●特性データ(参考データ) - 続き

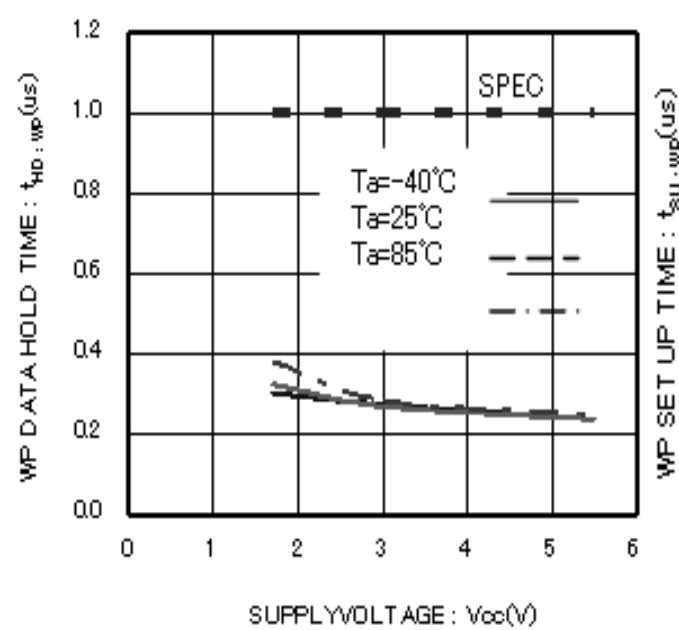


Figure 30. WP Hold Time t_{HD} : WP

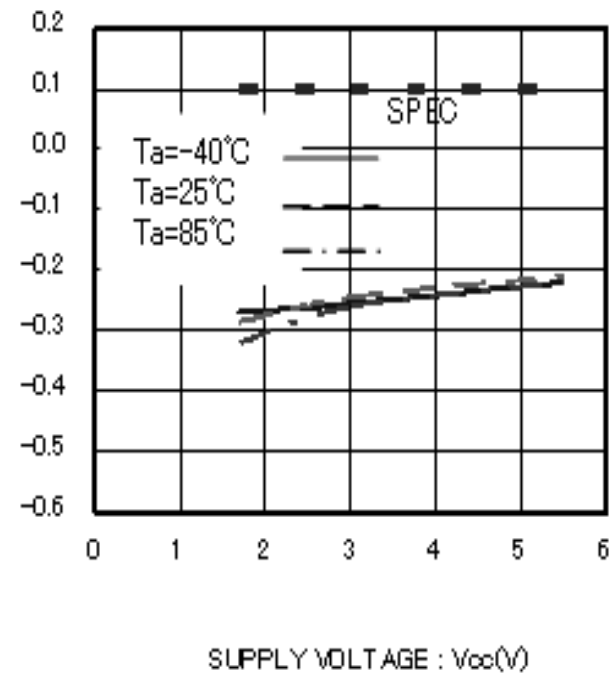


Figure 31. WP Setup Time t_{SU} : WP

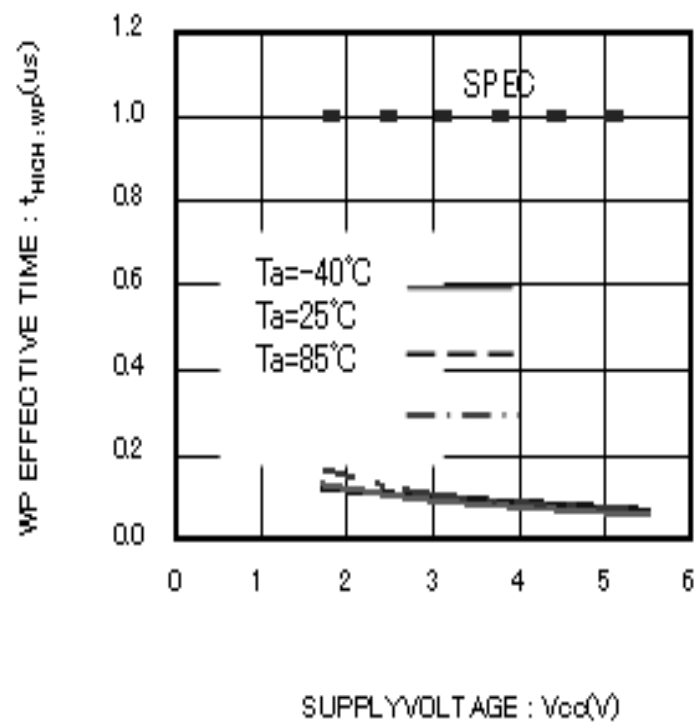


Figure 32. WP High Period t_{HIGH} : WP

●I²C BUS の通信

○I²C BUS のデータ通信

I²C BUS のデータ通信はスタートコンディション入力で始まり、ストップコンディション入力で終了します。データは必ず 8 ビット長になり、各バイトの後には必ずアクノリッジが必要になります。

I²C BUS はシリアルデータ(SDA)とシリアルクロック(SCL)の 2 本の通信線によってバスに接続された複数のデバイス間でデータ伝達を行います。

このデバイスには、クロックを生成し、通信開始・終了を制御する「マスタ」と各デバイス固有に持つアドレスによって制御される「スレーブ」があります。EEPROM は、「スレーブ」になります。また、データ通信中にバスにデータ出力を行うデバイスを「トランスミッタ」、受信するデバイスを「レシーバ」と呼びます。

○スタートコンディション(スタートビットの認識)

- ・各々の命令を実行する前に、SCL が"HIGH"となっている時に、SDA が"HIGH"から"LOW"へ立ち下がるようなスタートコンディション(スタートビット)となっていることが必要です。
- ・この IC は、常に SDA 及び SCL ラインがスタートコンディション(スタートビット)となっているかどうか検出していますので、この条件を満たさない限り、どのような命令も実行致しません。

○ストップコンディション(ストップビットの認識)

- ・各々の命令を終了するには、ストップコンディション(ストップビット)、即ち SCL が"HIGH"となっている時に、SDA が"LOW"から"HIGH"に立ち上がることによって、各々の命令を終了することができます。

○ソフトウェアによるライトプロテクト

- ・セットライトプロテクト命令またはパーマネントセットライトプロテクト命令によって 256 ワード内の 00~7F 番地のデータを書き換え禁止状態に設定します。セットライトプロテクト命令により設定された書き換え禁止状態はクリアライトプロテクト命令により解除することができます。パーマネントセットライトプロテクト命令により設定された書き換え禁止状態は、一度設定すると解除することが不可能ですので注意してください。これらの命令を行う時は WP 端子をオープンまたは GND にしてください。

○ACK 信号

- ・このアクノリッジ信号(ACK 信号)は、データ転送が正常に行われたかどうかを示すための、ソフトウェアの取り決めです。マスタでもスレーブでも、トランスミッタ(送信)側のデバイス(書き込み命令、読み出し命令のスレーブアドレス入力時は、 μ -COM、読み出し命令のデータ出力時は、この IC)は、8 ビットのデータの出力後にバスを開放するようになっています。
- ・レシーバ(受信)側のデバイス(書き込み命令、読み出し命令のスレーブアドレス入力時は、この IC、読み出し命令のデータ出力時は、 μ -COM)では、9 クロックサイクルの期間中、SDA を"LOW"とし、8 ビットデータを受信したというアクノリッジ信号(ACK 信号)を出力します。
- ・この IC は、スタートコンディションとスレーブアドレス(8 ビット)を認識した後、アクノリッジ信号(ACK 信号)"LOW"を出力します。
- ・各々のライト動作は、各々の 8 ビットデータ(ワードアドレス及びライトデータ)受信毎に、アクノリッジ信号(ACK 信号)"LOW"を出力します。
- ・各々のリード動作は、8 ビットデータ(リードデータ)を出力し、アクノリッジ信号(ACK 信号)"LOW"を検出します。アクノリッジ信号(ACK 信号)が検出され、且つマスタ(μ -COM)側からストップコンディションが送られて来ない場合には、この IC はデータの出力を継続します。アクノリッジ信号(ACK 信号)が検出されない場合には、この IC はデータ転送を中断し、ストップコンディション(ストップビット)を認識して、リード動作を終了します。そして、この IC は待機状態に入ります。

○デバイスのアドレッシング(スレーブアドレスの設定)

マスタから、スタートコンディションに続けてスレーブアドレスを入力してください。スレーブアドレスの上位 4 ビットは、デバイスタイプを識別するためのデバイスコードとして使用されます。この IC の、デバイスコードは"1010"と固定されております。またライトプロテクトレジスタへのアクセス時には、デバイスコードは、"0110"となります。その次の、スレーブアドレスの 3 ビット(A2、A1、A0)はデバイスの選択用で、入力された A2~A0 データと、入力端子 A2~A0 の状態が一致した時にのみこの IC は動作開始します。よって A2~A0 の組み合わせによって同一バス上にこの IC を最大 8 個まで接続することができます。

スレーブアドレスの最下位ビット(R/W...READ/WRITE)は、書き込みまたは読み出しの動作指定に使用され、以下のようになります。

- | | | |
|-------------|-------|-------------------------|
| R/W を 0 に設定 | | 書き込み(ランダムリードのワードアドレス設定) |
| R/W を 1 に設定 | | 読み出し |

スレーブアドレス 設定端子			デバイスタイプ	デバイスアドレス			READ WRITE モード	アクセスメモリ
A2	A1	A0	1010	A2	A1	A0	R / \overline{W}	通常の 2kbit メモリへアクセス
A2	A1	A0	0110	A2	A1	A0	R / \overline{W}	パーマネントセットライト プロテクトメモリへアクセス
GND	GND	VHV		0	0	1	R/ \overline{W}	セットライトプロテクトメモリアクセス
GND	Vcc	VHV		0	1	1	R/ \overline{W}	クリアライトプロテクトメモリアクセス

○ライトプロテクトピン(WP)

WP 端子を Vcc(H レベル)にするとライトプロテクト命令同様に、256 ワード全アドレスのデータ書き換えを禁止します。また、GND(L レベル)にすると通常の書き込みが行えます。ライトプロテクト命令によって書き換え禁止がされていると 00~7Fh 番地のデータは、WP 端子の状態によらず書き換えは禁止されます。WP 端子はブルダウン抵抗を内蔵していますので、プロテクト機能をご使用されない場合は、オープンまたは、GND にしてください。

○ACK 信号によるライトプロテクトレジスタの確認

ライトプロテクトの状態によって返ってくる ACK は以下の表のようになります。

ライトプロテクト レジスタの状態	WP 入力	入力コマンド	ACK	アドレス	ACK	データ	ACK	ライト サイクル (tWR)
PSWP で プロテクト されている場合	-	PSWP、SWP または CWP	無	-	無	-	無	無
		ページまたはバイトライト (00~7Fh 番地)	有	WA7~WA0	有	D7~D0	無	無
SWP で プロテクト されている場合	0	SWP	無	-	無	-	無	無
		CWP	有	-	有	-	有	有
		PSWP	有	-	有	-	有	有
		ページまたはバイトライト (00~7Fh 番地)	有	WA7~WA0	有	D7~D0	無	無
	1	SWP	無	-	無	-	無	無
		CSP	有	-	有	-	無	無
		PSWP	有	-	有	-	無	無
		ページまたはバイトライト	有	WA7~WA0	有	D7~D0	無	無
プロテクトされて いない場合	0	PSWP、SWP または CWP	有	-	有	-	有	有
		ページまたはバイトライト	有	WA7~WA0	有	D7~D0	有	有
	1	PSWP、SWP または CWP	有	-	有	-	無	無
		ページまたはバイトライト	有	WA7~WA0	有	D7~D0	無	無

ライト(R/ \overline{W} =0)時の ACK 信号

—は Don't Care

ライトプロテクト レジスタの状態	コマンド	ACK	アドレス	ACK	データ	ACK
PSWP でプロテクト されている場合	PSWP、SWP または CWP	無	-	無	-	無
SWP でプロテクト されている場合	SWP	無	-	無	-	無
	CWP	有	-	無	-	無
	PSWP	有	-	無	-	無
プロテクトされて いない場合	PSWP、SWP または CWP	有	-	無	-	無

リード(R/ \overline{W} =1)時の ACK 信号

●コマンド

○ライトサイクル

任意の DATA を EEPROM に書き込みます。1 バイトだけ書き込む場合バイトライトを通常使用しますが、2 バイト以上の連続 DATA を書き込む場合は、ページライトサイクルで同時に書き込みが可能です。書き込み可能バイト数は、最大 16 バイトまで任意のバイト数を書き込むことが可能です。

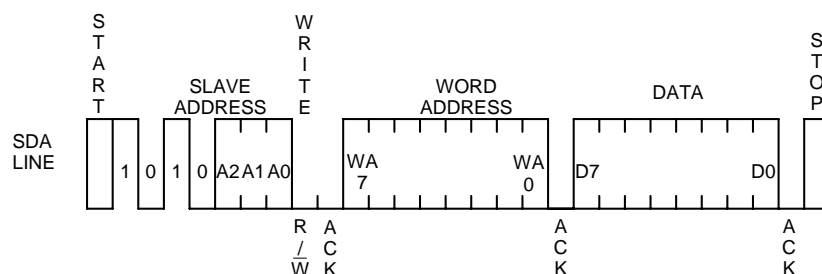


Figure 33. バイトライトサイクル

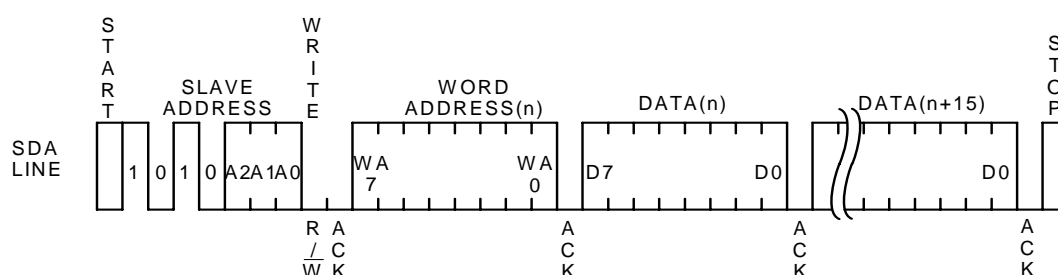


Figure 34. ページライトサイクル

- ・ワードアドレス(n 番地)で指定されたアドレスに DATA を書き込みます。
- ・8 ビットの DATA 入力後、ストップビットを発行することによって、メモリセル内部への書き込みを開始します。
- ・内部書き込みが開始されると、tWR(最大 5 ms)の間コマンドを受け付けません。
- ・ページライトサイクルにより最大 16 バイトを一括で書き込みが可能です。

また最大バイト数以上の DATA を送りますと 1 バイト目の DATA から上書きされることになります。

ページライトサイクルは、ワードアドレスの 8 ビットを任意に指定した後、2 バイト以上の DATA 入力を続けると、アドレスの下位 4 ビットは内部でアドレスがインクリメントされ、最大 16 バイトの DATA を書き込むことが可能です。

●コマンド

○リードサイクル

EEPROM のデータを読み出します。リードサイクルにはランダムリードサイクルとカレントリードサイクルがあります。ランダムリードサイクルはアドレスを指定して、データを読み出すコマンドで一般的に使用されます。カレントリードサイクルはアドレスを指定せず、内部アドレスレジスタのデータを読み出すコマンドで、ライトサイクル後すぐにペリファイする場合に使用されます。どちらのリードサイクルもシーケンシャルリードサイクルが可能で、引き続き次のアドレスのデータを読み出すことが可能です。

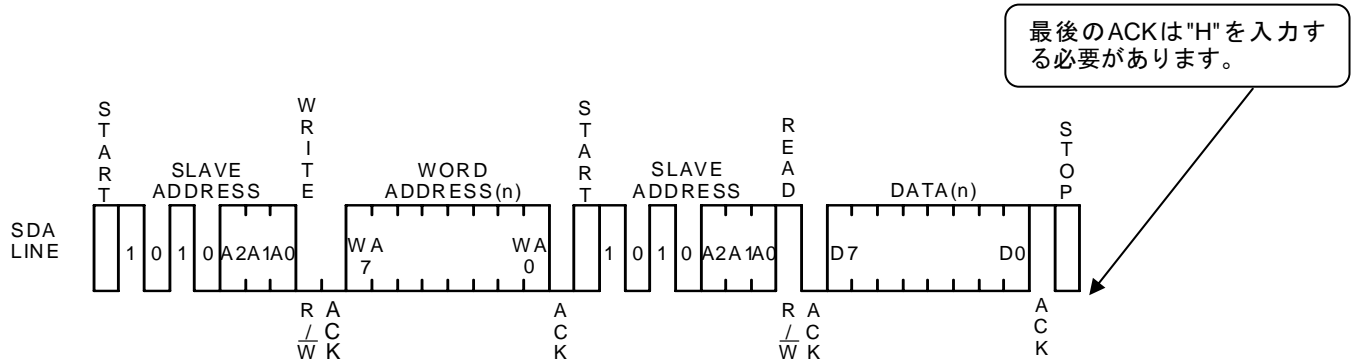


Figure 35. ランダムリードサイクル

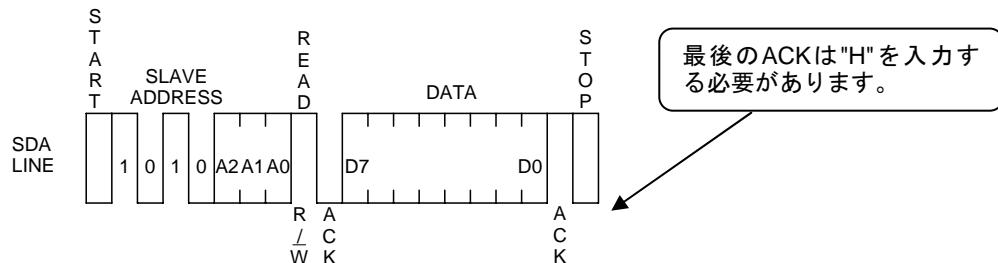


Figure 36. カレントリードサイクル

- ・ランダムリードサイクルは、指定したワードアドレスのデータを読み出すことができます。
- ・カレントリードサイクルの直前の命令がランダムリードサイクル、カレントリードサイクル(それぞれシーケンシャルリードサイクルを含む)の場合は最終読み出しアドレス(n)番地をインクリメントしたアドレス(n+1)番地のデータが出力されます。
- ・D0 後の ACK 信号"LOW"が検出され、且つマスタ(μ-COM)側からストップコンディションが送られていない場合、次のワードアドレスのデータを引き続き読み出すことができます。
- ・リードサイクルの終了は、D0 後の ACK 信号に"H"を入力し SCL 信号"H"で SDA 信号を立ち上げるストップコンディションによって終了されます。
- ・D0 後の ACK 信号に"H"を入力せずに"L"を入力するとシーケンシャルリードサイクルになり、次のデータが出力されてしまいます。したがって、リードコマンドサイクルは終了できません。リードコマンドサイクルを終了する場合は必ず、D0 後の ACK 信号に"H"を入力し、SCL 信号"H"で SDA を立ち上げるストップコンディションを入力してください。

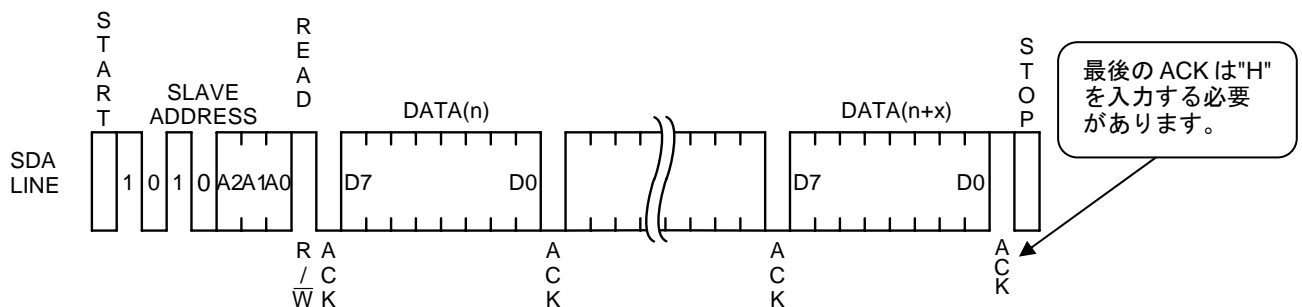


Figure 37. シーケンシャルリードサイクル(カレントリードサイクルの場合)

●ライトプロテクトサイクル

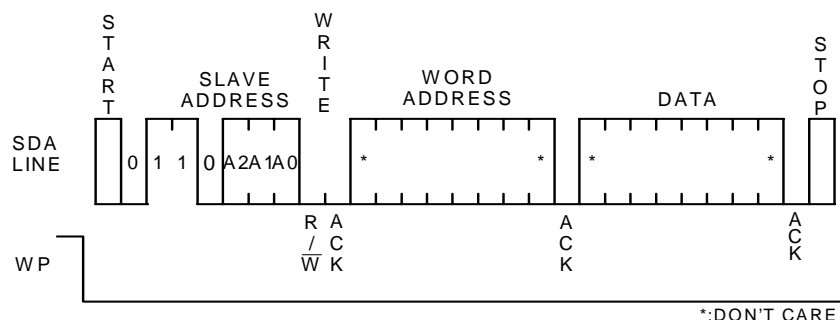


Figure 38. パーマネントセットライトプロテクトサイクル

- ・ パーマネントセットライトプロテクト命令によって 256 ワードのうちの 00 から 7Fh 番地のデータの書き換えを禁止します。パーマネントセットライトプロテクト命令を 1 度実行しますと、書き換え禁止状態を解除することは不可能となります(ワンタイムメモリ)既にパーマネントセットライトプロテクトされている状態でこの命令を入力しても、コマンドはキャンセルされます。パーマネントセットライトプロテクト命令時、WP 端子はオープンまたは GND に接続してください。
- ・ パーマネントセットライトプロテクト命令は、バイトライトやページライトと同様にストップコンディションから tWR の内部書き込みサイクル時間を必要とします。tWR 中に次のコマンドを入力しましてもコマンドはキャンセルされます。
- ・ 各プロテクト状態時に対する ACK の応答は 14 ページを参照。

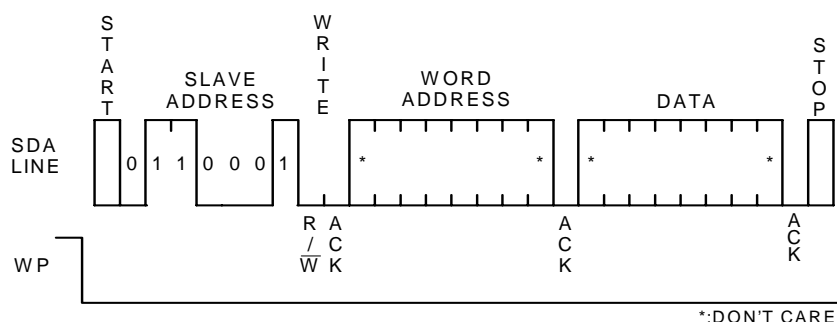


Figure 39. セットライトプロテクトサイクル

- ・セットライトプロテクト命令によって 256 ワードのうちの 00 から 7Fh 番地のデータの書き換えを禁止します。セットライトプロテクト命令で設定された書き換え禁止状態は、クリアライトプロテクト命令で解除できます。既にプロテクトされている状態でセットライトプロテクト命令を入力しても、コマンドはキャンセルされます。セットライトプロテクト命令時、WP 端子はオープンまたは GND に接続してください。
- ・セットライトプロテクト命令は、バイトライトやページライトと同様にストップコンディションから tWR の内部書き込みサイクル時間を必要とします。tWR 中に次のコマンドを入力しましてもコマンドはキャンセルされます。
- ・各プロテクト状態時に対する ACK の応答は 14 ページを参照。

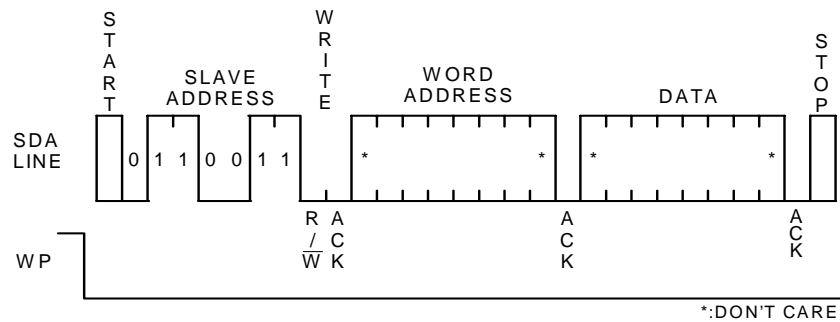


Figure 40. クリアライトプロテクトサイクル

- ・クリアライトプロテクト命令によって、セットライトプロテクト命令により設定された書き換え禁止状態を解除します。クリアライトプロテクト命令時、WP 端子はオープンまたは GND に接続してください。
- ・クリアライトプロテクト命令は、バイトライトやページライトと同様にストップコンディションから tWR の内部書き込みサイクル時間を必要とします。tWR 中に次のコマンドを入力しましてもコマンドはキャンセルされます。
- ・各プロテクト状態時に対する ACK の応答は 14 ページを参照。

●ソフトウェアリセットについて

ソフトウェアリセットは、電源の立ち上がり後の誤動作を回避するために使用する場合は、コマンド入力中にリセットをかける必要のある場合などに実行してください。3 種類の例を下図に示します (Figure 41-(a)、Figure 41-(b)、Figure 41-(c) 参照)。ダミークロック入力区間では SDA バスを解放 (プルアップによる "H") としてください。ダミークロック区間では EEPROM より ACK 出力やリードデータ "0" (ともに "L" レベル) が出力されることが考えられますので強制的に "H" を入力されますと、出力がコンフリクトし過電流が流れ、システム電源の瞬停や場合によってはデバイスへの影響が考えられます。

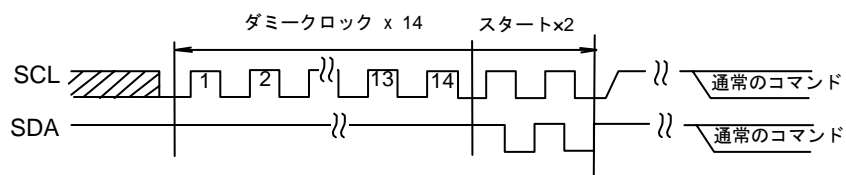


Figure 41-(a). ダミークロック x 14 + START + START + コマンド入力の場合

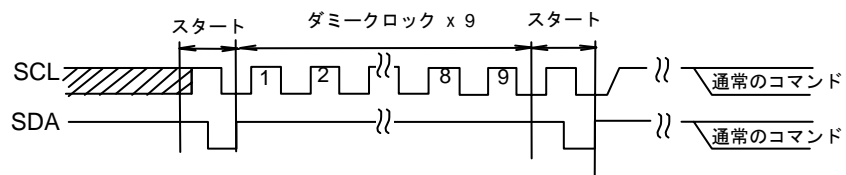


Figure 41-(b). START + ダミークロック x 9 + START + コマンド入力の場合

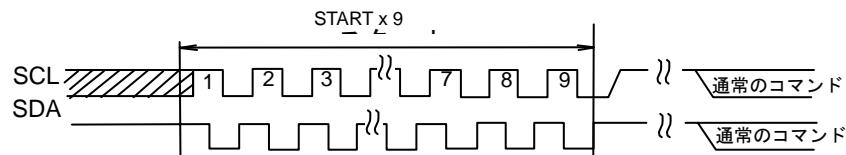


Figure 41-(c). START x 9 + コマンド入力の場合

*通常のコマンドは START 入力から始めてください。

●アクノリッジポーリングについて

内部書き込み実行中は、すべての入力コマンドを無視するために ACK を返しません。ライトコマンド入力後の内部自動書き込み実行中に次のコマンド(スレーブアドレス)を送り、最初の ACK 信号が"L"を返してきたら書き込み動作の終了を、"H"であれば書き込み中を意味します。アクノリッジポーリングを用いることで $t_{WR}=5\text{ms}$ を待たずに、次のコマンドを実行することができます。

連続して書き込みを行う場合は、 $R\overline{W}=0$ 、書き込み後カレントリードを行う場合は、 $R\overline{W}=1$ としたスレーブアドレスを送り、ACK 信号が"L"を返してきたら、それぞれワードアドレス入力やデータ出力などを続けて実行してください。

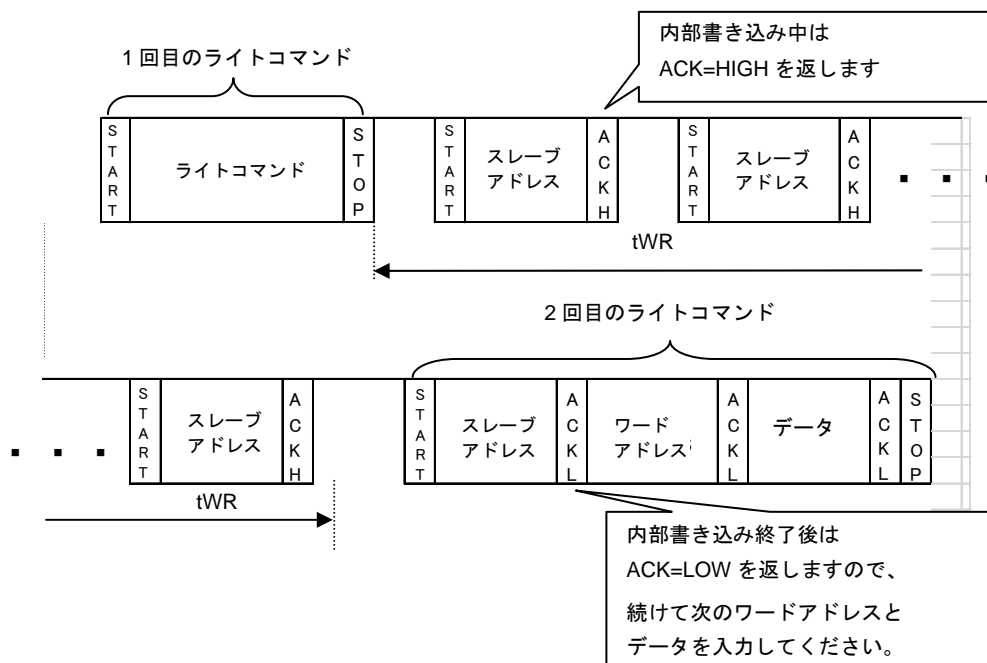


Figure 42. アクノリッジポーリングで連続して書き込みを行う場合

●WP 有効タイミングについて

WP は通常、"H" or "L" に固定して使用されますが、WP をコントロールしてライトコマンドのキャンセルなどに使用する場合、下記の WP 有効タイミングに注意して使用してください。

ライトコマンド実行中にキャンセル有効区間で、WP="H" とするとライトコマンドをキャンセルすることができます。バイトライト、ページライトのどちらもコマンドの最初のスタートコンディションからワードアドレス、そしてデータ(ページライトでは最初の 1 バイト目のデータ)の D0 を取り込むクロックの立ち上がり前までの区間がキャンセル無効区間です。この間の WP 入力は Don't Care となります。D0 取り込みの SCL の立ち上がりに対するセットアップ時間は 100ns 以上にしてください。

D0 を取り込む SCL の立ち上がりから内部自動書き込み(t_{WR})が終了するまでの間がキャンセル有効区間となります。また、 t_{WR} の間に WP="H" とした場合、書き込みを強制的に終了させるため、アクセス中のアドレスのデータは保証されませんので再度書き込みをしてください(下図参照)。

WP による強制終了実行後は、待機状態となりますので、 $t_{WR}(5\text{ms Max.})$ を待つ必要はありません。

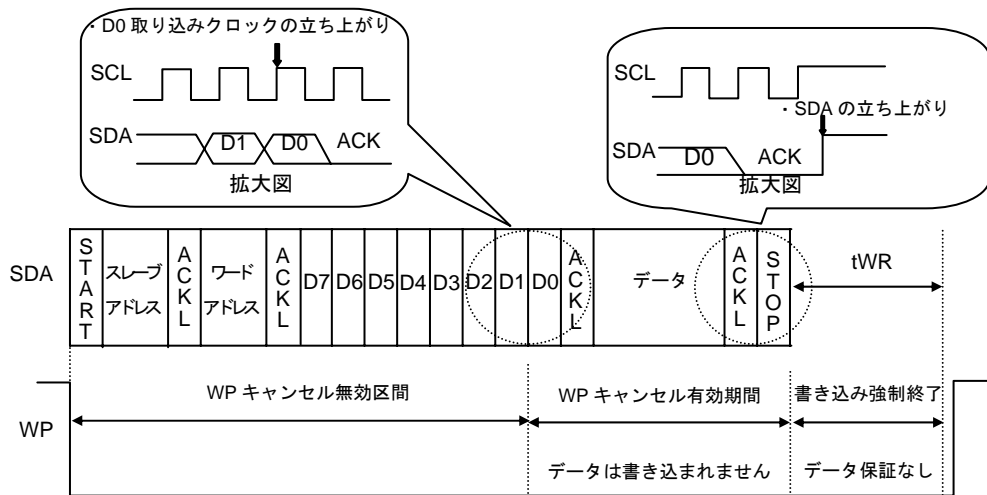


Figure 43. WP 有効タイミング

●スタートコンディション、ストップコンディションによるコマンドキャンセルについて

コマンド入力途中で、スタートコンディション、ストップコンディションを続けて入力することでコマンドキャンセルすることができます。(Figure 44)

ただし、ACK 出力区間やデータ読み出し中は SDA バスが "L" 出力となっている場合があります、その場合スタートコンディションやストップコンディションが入力できなくなりますのでリセットはできません。その場合は、ソフトウェアリセットを実行してください。(Figure 41)

また、ランダムリードやシーケンシャルリード、カレントリード中に、スタート、ストップコンディションでコマンドキャンセルをした場合、内部の設定アドレスが確定しませんので、続けてカレントリードを行うことはできません。続けてリードをする場合は、ランダムリードを行ってください。

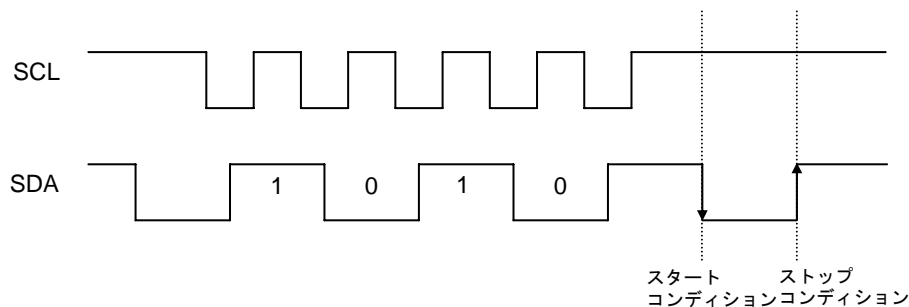


Figure 44. スレーブアドレス入力中にスタート・ストップコンディションでキャンセルした場合

●I/O 周辺回路について

○SDA 端子のプルアップ抵抗

SDA は NMOS オープンドレインとなっておりますのでプルアップ抵抗が必要です。この抵抗値(RPU)は、本 IC を制御するマイコンなどの VIL、IL 及び本 IC の VOL-IOL 特性より適切な値を選択してください。RPU が大きいと動作周波数が制限されます。RPU が小さいほど、動作消費電流が増加します。

○RPU の最大値

RPU の最大値は以下の要因で決定されます。

- ①RPU と SDA のバスラインの容量(CBUS)で決定される SDA の立ち上がり時間が t_R 以下であること。また SDA の立ち上がり時間が遅くなっても AC タイミングを満たしていること。
- ②SDA バスに "H" を出力している時のバスにつながるデバイスの入力リークの合計(IL)と RPU で決まるバスの電位(A)がマイコンと EEPROM の入力 "H" レベル(VIH)を推奨ノイズマージン $0.2 V_{CC}$ を含めて充分確保できること。

$$V_{CC} - IL \cdot RPU - 0.2 V_{CC} \geq V_{IH}$$

$$\therefore RPU \leq \frac{0.8 V_{CC} - V_{IH}}{IL}$$

例) $V_{CC} = 3V$ $IL = 10\mu A$ $V_{IH} = 0.7 V_{CC}$ の時
②より

$$RPU \leq \frac{0.8 \times 3 - 0.7 \times 3}{10 \times 10^{-6}} \\ \leq 300 [\Omega]$$

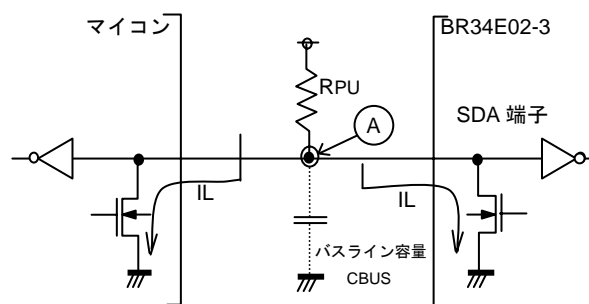


Figure 45. I/O 回路図

○RPU の最小値

RPU の最小値は以下の要因で決定されます。

①IC が LOW を出力した時に、VOLMAX=0.4V IOLMAX=3mA を満たすこと

$$\frac{V_{CC}-V_{OL}}{R_{PU}} \leq I_{OL}$$

$$\therefore R_{PU} \geq \frac{V_{CC}-V_{OL}}{I_{OL}}$$

②VOLMAX=0.4V がマイコン、EEPROM の入力"1"レベル(VIL)を推奨ノイズマージン 0.1 Vcc を含めて確保できること

$$V_{OLMAX} \leq V_{IL}-0.1 V_{CC}$$

例) Vcc =3V、VOL=0.4V、IOL=3mA、マイコン、EEPROM の VIL=0.3 Vcc の時

$$\text{①より } R_{PU} \geq \frac{3-0.4}{3 \times 10^{-3}}$$

$$\geq 867 [\Omega]$$

$$\text{また } V_{OL}=0.4 [V]$$

$$\text{And } V_{IL}=0.3 \times 3 \\ =0.9 [V]$$

より、②の条件を満たしている。

○SCL 端子のプルアップ抵抗

CMOS 出力ポートで SCL 制御を行っている場合は動作上必要ありませんが、SCL が"Hi-Z"となるタイミングがある場合は、プルアップ抵抗を付けてください。プルアップ抵抗は、マイコンの出力ポートのドライブ能力との兼ね合いで数 kΩ ~ 数 kΩ を推奨します。

●A0、A1、A2、WP の処理について

○デバイスアドレス端子(A0、A1、A2)の処理

設定されたデバイスアドレスはマスタ側から送られてくるデバイスアドレス入力と一致するか照合し、同一バスに複数に接続されたデバイスの中からひとつ選択します。この端子は、プルアップ or プルダウン、あるいは Vcc or GND に接続してください。

○WP 端子の処理

WP 端子はハードウェア的に書き込みを禁止、許可をする端子です。"H"の状態では、READ のみ可能で全アドレスの WRITE を禁止します。"L"の場合はどちらでも可能です。

ROM として使用する場合は、プルアップ or Vcc に接続することを推奨します。

READ、WRITE とも使用する場合は、WP 端子をコントロールするかオープン、または GND に接続してください。

(WP 端子は内部にプルダウン抵抗がついていますので、オープンでも可能です。)

●マイコン接続時の注意

○Rs について

I²C BUS では、SDA ポートはオープンドレイン入出力が推奨されています。しかし、SDA ポートにトリステートの CMOS 入出力を使用する場合には、プルアップ抵抗 RPU と EEPROM の SDA 端子の間にシリアル抵抗 Rs を挿入してください。これはマイコンの PMOS と EEPROM の NMOS の同時オンの時に発生する過電流の制限をします。Rs は SDA 端子のサージからの保護の役目もします。したがって、SDA ポートがオープンドレイン入出力であっても RS を使用することができます。

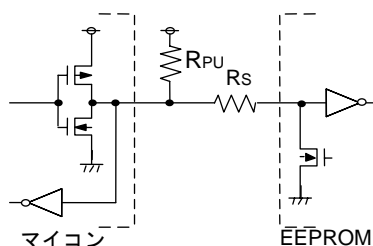


Figure 46. I/O 回路図

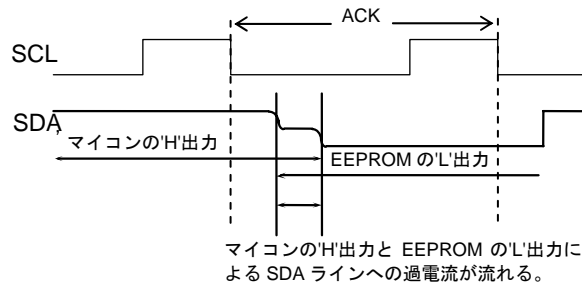


Figure 47. 入出力衝突タイミング

○Rsの最大値

Rsの最大値は以下の関係で決定されます。

- ①RPUとSDAのバスラインの容量(CBUS)で決定されるSDAの立ち上がり時間が t_R 以下であること。またSDAの立ち上がり時間が遅くなっても、ACタイミングを満たしていること。
- ②EEPROMがSDAバスに"L"を出力している時のRPUとRsで決定されるバスの電位(A)がマイコンの入力"L"レベル(VIL)を推奨ノイズマージン $0.1V_{CC}$ を含めて充分確保できること。

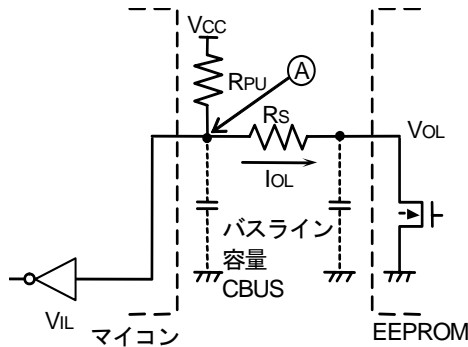


Figure 48. I/O 回路図

$$\frac{(V_{CC}-V_{OL}) \times R_{PU}}{R_{PU}+R_S} + V_{OL} + 0.1V_{CC} \leq V_{IL}$$

$$\therefore R_S \leq \frac{V_{IL}-V_{OL}-0.1V_{CC}}{1.1V_{CC}-V_{IL}} \times R_{PU}$$

例) $V_{CC}=3V$ $V_{IL}=0.3V_{CC}$ $V_{OL}=0.4V$ $R_{PU}=20k\Omega$ の時

$$\textcircled{2} \text{より } R_S \leq \frac{0.3 \times 3 - 0.4 - 0.1 \times 3}{1.1 \times 3 - 0.3 \times 3} \times 20 \times 10^3$$

$$\leq 1.67 [k\Omega]$$

○Rsの最小値

Rsの最小値はバス衝突時の過電流によって決定されます。過電流が流れますと電源ラインのノイズや、電源の瞬停の原因となります。

許容可能な過電流をIとすると、以下の関係を満たす必要があります。

セットでの電源ラインのインピーダンスなどを考慮し許容できる電流量を決定してください。

EEPROMへの過電流は、10mA以下としてください。

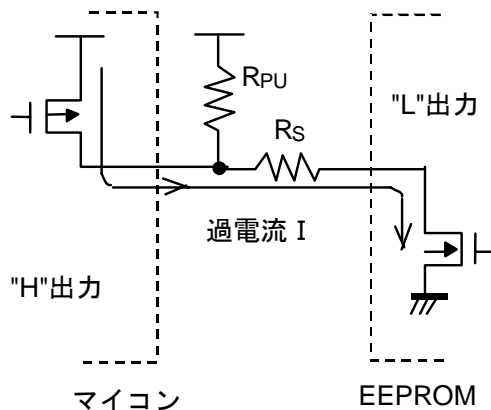


Figure 49. I/O 回路図

$$\frac{V_{CC}}{R_S} \leq I$$

$$\therefore R_S \geq \frac{V_{CC}}{I}$$

例) $V_{CC}=3V$ 、 $I=10mA$ の時

$$R_S \geq \frac{3}{10 \times 10^{-3}}$$

$$\geq 300 [\Omega]$$

●I²C BUS 入出力回路について

○入力(A0、A1、A2、SCL)

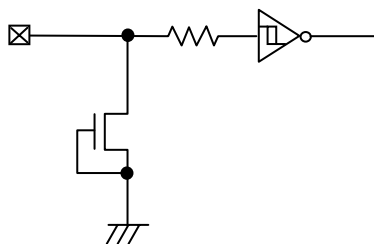


Figure 50. 入力 pin 回路図

○入力(SDA)

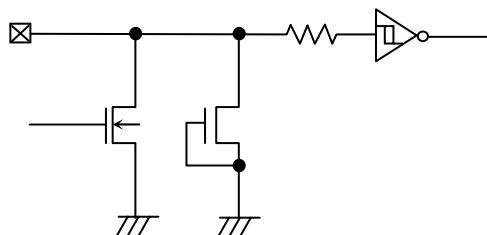


Figure 51. 入力 pin 回路図

○入力(WP)

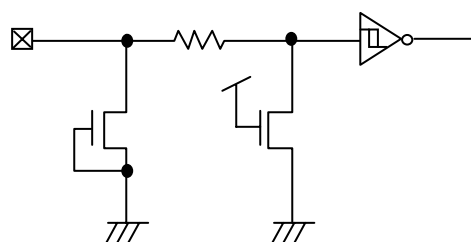


Figure 52. 入力 pin 回路図

●電源立ち上げ時の注意

電源立ち上がり時は、IC 内部回路及びセットが不安定な低電圧領域を通過して V_{CC} が立ち上がるため IC の内部が完全にリセットされずに誤動作を起こす恐れがあります。これを防ぐために P.O.R.回路と LVCC 回路の機能を付けています。その動作を確実なものにするために、電源立ち上がり時には以下の条件を守ってください。

1. SDA="H"かつ SCL="L" or "H"としてください。
2. P.O.R.回路を動作させるための、 t_R 、 t_{OFF} 、 V_{bot} の推奨条件を満たすよう、電源を立ち上げてください。

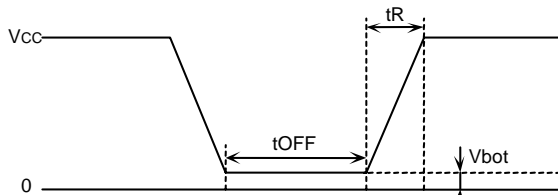


Figure 53. 立ち上がり波形図

tR, tOFF, Vbot の推奨条件

tR	tOFF	Vbot
10ms以下	10ms以上	0.3V以下
100ms以下	10ms以上	0.2V以下

3. SDA、SCL が "Hi-Z" にならないようにしてください。
上記の条件 1、2 が守れない場合は、以下のような対策を行ってください。
a) 上記条件 1 が守れない時。電源立ち上がり時に SDA が "L" になってしまう時。
→ 以下のように SCL、SDA をコントロールし、SCL、SDA を "H"、"H" とする。

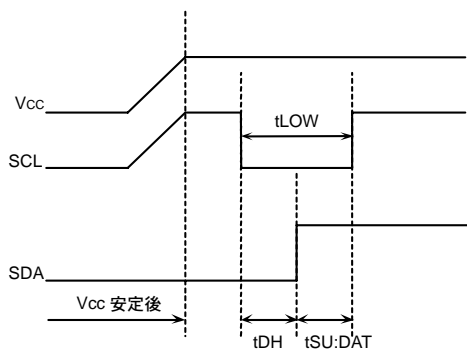


Figure 54. SCL="H" SDA="L" の時

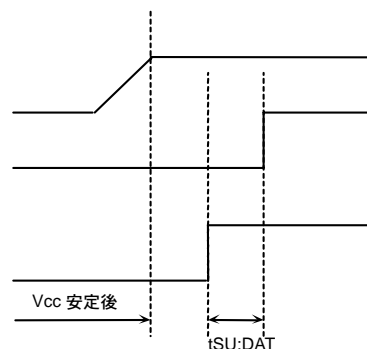


Figure 55. SCL="L" SDA="L" の時

- b) 上記条件 2 が守れない時。
→ 電源安定後、ソフトウェアリセット (Figure 41) を実行してください。
- c) 上記条件 1、2 ともに守れない時。
→ a) を行った後、b) を行ってください。

●低電圧誤動作防止機能

減電時にデータの書き換え動作を禁止し、誤書き込みを防止するのが LVCC 回路です。LVCC 電圧 (Typ. 1.2V) 以下では、データの書き換えは行わないように制限します。

●Vcc ノイズ対策

○バイパスコンデンサについて

電源ラインへノイズやサージが入ると誤動作を起こす可能性がありますので、これらを取り除くために IC の V_{CC} と GND 間にバイパスコンデンサ (0.1μF) を取り付けることを推奨します。その際、できるだけ IC の近くに取り付けてください。また、基盤の V_{CC} -GND 間にもバイパスコンデンサを取り付けることを推奨します。

●使用上の注意

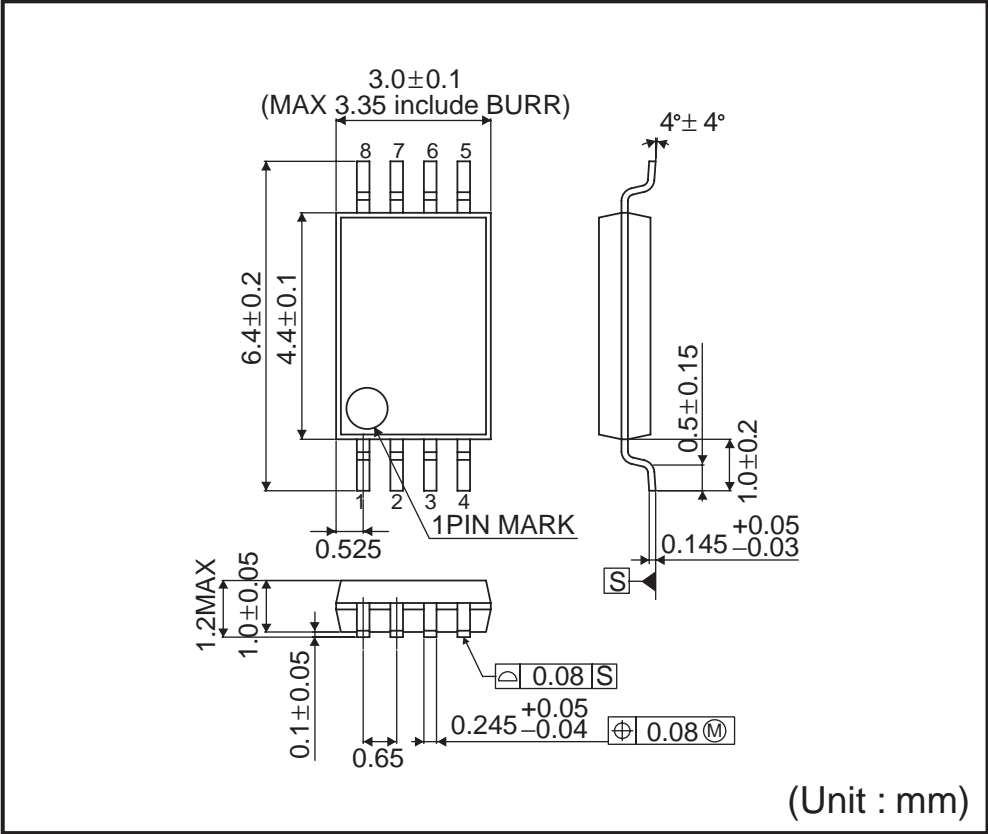
- 1) 記載の数値及びデータは設計代表値であり、その値を保証するものではありません。
- 2) アプリケーション回路例は推奨すべきものと確信しておりますが、ご使用にあたっては更に特性のご確認を充分にお願いします。外付け部品定数を変更してご使用になる時は、静特性のみならず過渡特性も含め外付け部品及び弊社 LSI のばらつきなどを考慮して十分なマージンを見て決定してください。
- 3) 絶対最大定格について
印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、LSI が破壊することがあります。絶対最大定格を超える電圧及び温度を印加しないでください。絶対最大定格を超えるようなことが考えられる場合には、ヒューズなどの物理的な安全対策を実施して頂き、LSI に絶対最大定格を超える条件が印加されないようご検討ください。
- 4) GND 電位について
GND 端子の電圧はいかなる動作状態においても、最低電圧になるようにしてください。過渡現象も含めて、各端子電圧が GND 端子よりも低い電圧になっていないことを実際にご確認ください。
- 5) 熱設計について
実使用状態での許容損失を考慮して、十分なマージンを持った熱設計を行ってください。
- 6) 端子間ショートと誤実装について
LSI を基板に実装する時には、LSI の方向や位置ずれに十分注意してください。誤って実装し通電した場合、LSI を破壊することがあります。また、LSI の端子間や端子と電源間、端子と GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊することがあります。
- 7) 強電磁界内での動作について
強電磁界での使用は、誤動作をする可能性がありますので十分ご評価ください。

●発注形名情報

	B	R	3	4	E	0	2	x	x	x	-	3	x	x
BUS タイプ														
34 : I ² C														
動作温度														
-40℃~+85℃														
容量														
02=2K														
パッケージ														
FVT :TSSOP-B8														
NUX :VSON008X2030														
プロセスコード														
包装、フォーミング仕様														
E2 : リール状エンボステーピング														
(TSSOP-B8)														
TR : リール状エンボステーピング														
(VSON008X2030)														

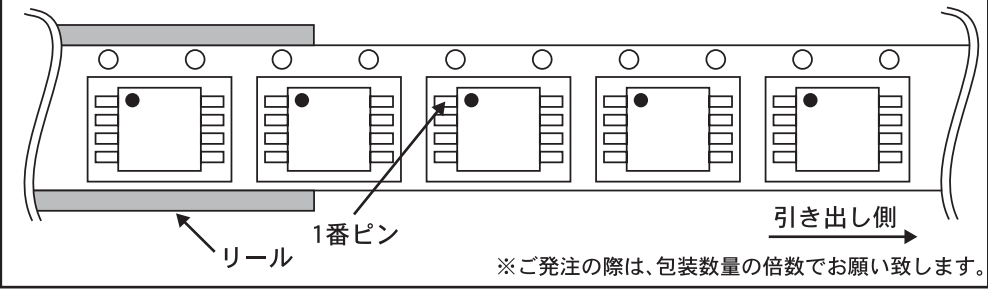
●外形寸法図と包装・フォーミング仕様

TSSOP-B8



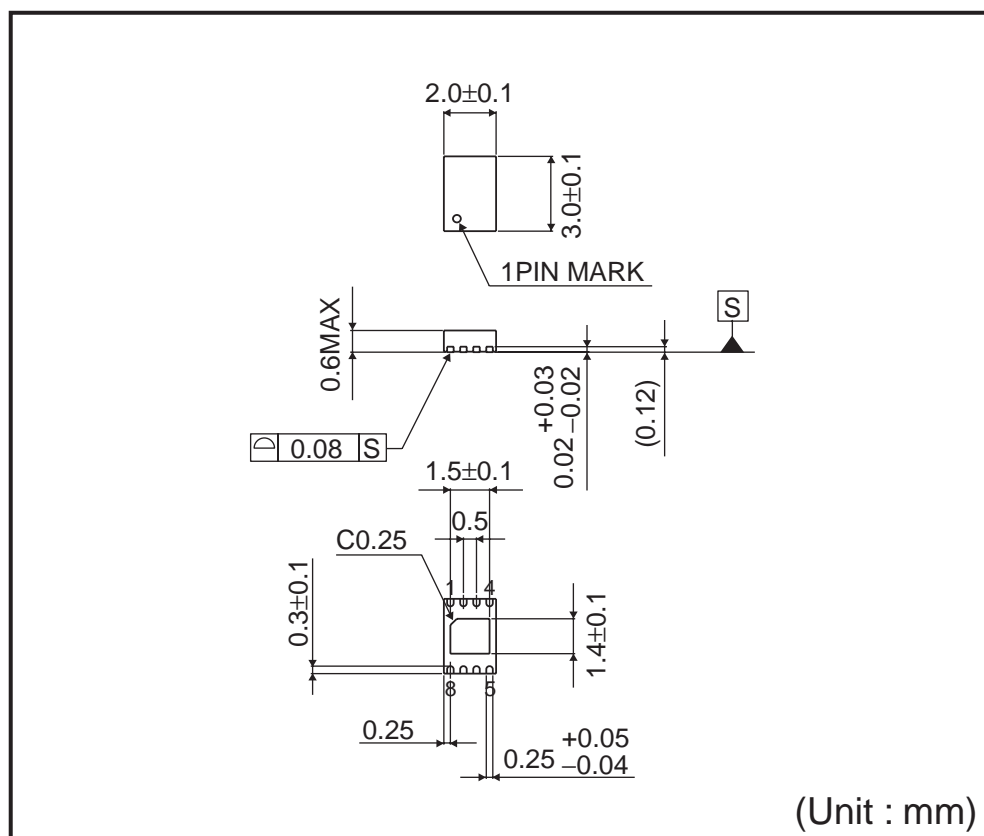
＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向



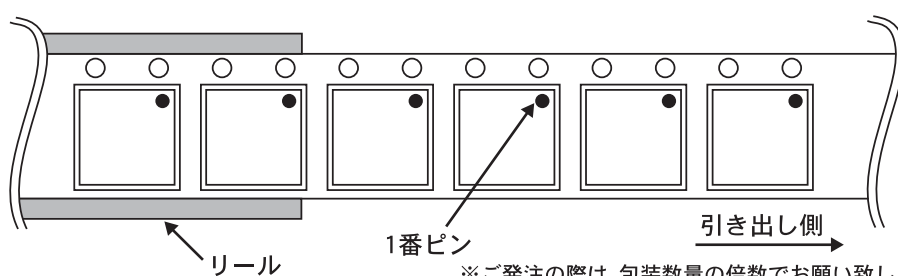
●外形寸法図と包装・フォーミング仕様 - 続き

VSON008X2030



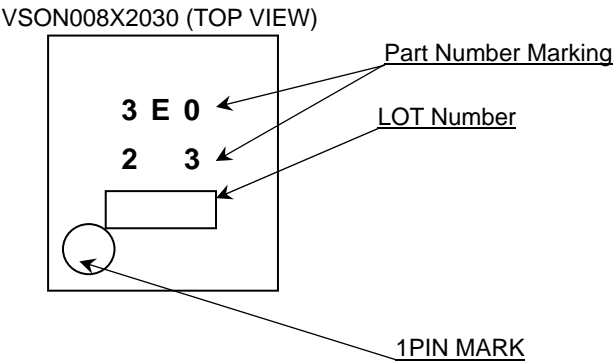
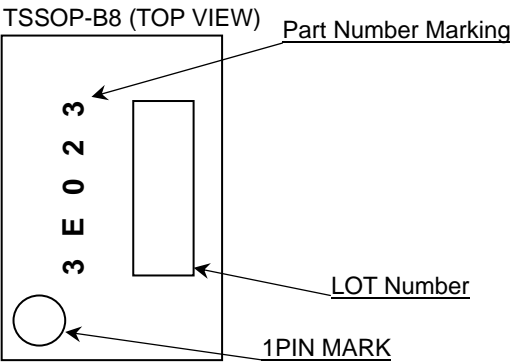
＜包装仕様＞

包装形態	エンボステープिंग
包装数量	4000pcs
包装方向	TR (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに 製品の1番ピンが右上にくる方向)



※ご注文の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

●標印図



●改訂記録

日付	Revision	改訂内容
2012.9.07	001	New Release
2013.2.25	002	英文と Revision を合わせるため、Revision 変更
2013.5.31	003	P.1 パッケージラインアップ表を追加 絶対最大定格に静電破壊耐圧値を追記 P.4 端子説明に補足を追記

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂ 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実に行うことをお勧め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けはリフローはんだを原則とさせていただきます。なお、フロー方法でのご使用につきましては別途ロームまでお問い合わせください。
詳細な実装及び基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに QR コードが印字されていますが、QR コードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権侵害の責任、及び本製品の使用により発生するその他の責任に関し、ロームは一切その責任を負いません。
2. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。